LIQUID CRYSTALLINE OPTICAL FILM AND COMPENSATION FILM FOR LIQUII CRYSTAL DISPLAY ELEMENT CONSISTING OF LIQUID CRYSTALLINE OPTICAL FILM AS WELL AS LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE HAVING THIS COMPENSATION FILM

Publication number: JP9026572

Publication date:

1997-01-28

Inventor:

KOBORI YOSHIHIRO; TOYOOKA TAKEHIRO; MAZAKI

HITOSHI; SATO YASUSHI

Applicant:

NIPPON OIL CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/20; C09K19/32; C09K19/34; G02B5/30;

G02F1/1335; G02F1/13363; G02F1/13363; G02B5/20;

C09K19/32; C09K19/34; G02B5/30; G02F1/13; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/1335; C09K19/32;

C09K19/34; G02B5/20

- european:

C09K19/32; G02B5/30L

Application number: JP19950206379 19950711 Priority number(s): JP19950206379 19950711 Also published as:

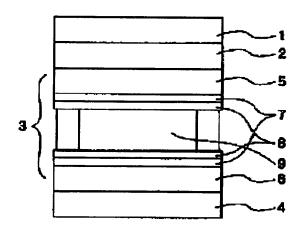
屋 EP0758013 (A⁻ 図 US5855971 (A

EP0758013 (B

Report a data error he

Abstract of JP9026572

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the simultaneous compensation of both of a twisted structure occurring in a liquid crystal cell and refractive index anisotropy possible in order to lessen the dependency of a liquid crystal display on visual sensation by twist orienting and immobilizing discoid liquid crystals. SOLUTION: The film obtd. by immobilizing the orientation state of the liquid crystals in a liquid crystal state is formed of the discoid liquid crystal material. The orientation form of the discoid liquid crystals is twist orientation. Namely, the discoid liquid crystalline material is used and the twist orientation which the liquid crystals form in a liquid crystal state, more specifically the orientation form having the twisted structure are immobilized without impairing the orientation form. This liquid crystal display element is composed of an upper polarizing plate 1, a compensation film 2, the liquid crystal cell 3, a lower polarizing plate 4, an upper substrate 5 of the liquid crystal cell 3, a lower substrate 6 of the liquid crystal cell 3, transparent electrodes 7, an oriented film 8 and nematic liquid crystals 9.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3445689号

(P3445689)

(45)発行日 平成15年9月8日(2003.9.8)

(24)登録日 平成15年6月27日(2003.6.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ	
G02F	1/13363			G 0 2 F	1/13363
C09K	19/32			C09K	19/32
	19/34				19/34
G 0 2 B	5/20			G 0 2 B	5/20

請求項の数6(全79頁)

(21)出願番号	特願平7-206379	(73)特許権者	000004444
			新日本石油株式会社
(22)出顧日	平成7年7月11日(1995.7.11)		東京都港区西新橋1丁目3番12号
•		(72)発明者	小堀 良浩
(65)公開番号	特開平9-26572		神奈川県横浜市中区千島町8番地 日本
(43)公開日	平成9年1月28日(1997.1.28)		石油株式会社中央技術研究所内
審査請求日	平成12年12月6日(2000, 12, 6)	(72)発明者	豊岡 武裕
	1 MID 12/1 0 H (2000/12/0)	(12/)25/14	神奈川県横浜市中区千島町8番地 日本
		(70) South 45	石油株式会社中央技術研究所内
		(72)発明者	真崎 仁詩
			神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本
			石油株式会社中央技術研究所内
		(74)代理人	100071755
			弁理士 斉藤 武彦
		審査官	山口 裕之
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶性光学フィルムおよび液晶性光学フィルムから成る液晶表示素子用補償フィルム並びに該補 償フィルムを備えた液晶表示装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶状態における液晶の配向形態を固定 化したフィルムにおいて、該フィルムがディスコティッ ク液晶性材料から形成され、該ディスコティック液晶の 配向形態が、ねじれ配向であり、かつディスコティック 液晶のダイレクターとフィルム平面法線とがなす角度 が、フィルムの厚さ方向に変化した状態で固定化された ものであることを特徴とする液晶性光学フィルム。

1

【請求項2】 ディスコティック液晶性材料が、少なく とも1種の光学活性な化合物を含有することを特徴とす 10 る請求項1記載の液晶性光学フィルム。

【請求項3】 少なくとも1種の光学活性な化合物が、 光学活性なディスコティック液晶性化合物であることを 特徴とする<u>請求項2記載</u>の液晶性光学フィルム。

【請求項4】 ディスコティック液晶のダイレクターと

フィルム平面法線とがなす角度が、フィルムの上面と下 面とで異なることを特徴とする請求項1乃至3のいずれ か1項に記載の液晶性光学フィルム。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか1項に記載の 液晶性光学フィルムから成ることを特徴とする液晶表示 素子用補償フィルム。

【請求項6】 請求項5記載の補償フィルムを1枚また は複数枚備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶ディスプレ 一、光エレクトロニクス、光学分野で有用な液晶性光学 フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】液晶の配向形態を固定化したフィルム

は、液晶構造に由来する特異な光学的性質を示すと共 に、環境に対して優れた耐性を示すユニークな材料であ る。一般に液晶は、大きな複屈折を持ち、また配向形態 も多様性に富んでおり、複屈折性の延伸フィルム等では 得ることのできない光学性能を発揮することが可能であ る。近年、液晶の性質、特に配向形態に伴う特異な光学 的性質を利用するために、該形態の固定化に関して種々 の報告が成されている。例えば特開平3-87720号 公報には、ねじれネマチック配向を固定化した膜を液晶 表示素子用補償板の構成材料として用いたものに関し て、また特開昭64-65124号公報には、スメクチ ック液晶性ポリエステルからなる光学フィルターに関し て、さらに特開平6-186534号公報には、コレス テリック液晶性フィルムの製造方法について、それぞれ 開示されている。前記公報からも分かるように、液晶の 配向形態を固定化して形成された膜、フィルムなどは、 液晶の配向形態に基づく特異な光学的性質を利用し、光 学分野、特に液晶ディスプレー分野の技術開発に大きく 貢献しうるものである。

【0003】液晶ディスプレーは、低電圧駆動、軽量、 低コストなどの特徴のゆえに、ディスプレー分野におい ては、従来のブラウン管に替わり大きな地位を占めつつ ある。液晶ディスプレーは、光学的に異方性を持った液 晶性物質の配向挙動を利用して表示させる方式である。 そのため液晶ディスプレーの表示画面においては、見る 方向によって画面の色調が変化するという問題(以下、 視角依存性という)を本質的に避け得ない。また液晶デ ィスプレーに、例えば延伸フィルムや補償用液晶セルな どの色補償光学素子を装着した際には、さらに視角依存 性が顕著となる。例えは、ツイステッドネマチックモー 30 ド(以下、TNと略す)あるいはスーパーツイステッド ネマチックモード(以下、STNと略す)を利用したパ ーソナルコンピューターまたはワードプロセッサーなど のディスプレーは、表示画面を正面から見た際には、比 較的良好な画像が得られる。しかしながら、正面以外の 方向から表示画面を見た際には画面が着色したり、画像 が見難くなったりする場合がある。こうした液晶ディス プレーの視角依存性は、使用者から好まれないばかりで なく、例えば液晶ディスプレーを利用した壁掛けタイプ などの大画面テレビに要求される大画面化に対応できな 40 いといった問題も生じる。すなわち大画面のディスプレ ーを利用した場合、従来の技術では表示画面を正面から 見たとしても周辺部では、大画面であるがゆえにある程 度の視角がついてしまう。そのため画面全体にわたって は、鮮明な画像を得られないことになる。

【0004】上記の如きディスプレーの視角依存性を軽 減する補償手段として、厚み方向の屈折率が面内の屈折 率よりも大きなフィルムが有効であることが示唆され

(M. Akatuka et al. : Japan d

の要求を満たす補償板が、例えば特開平5-27235 号公報および特開平5-53104号公報などに開示さ れている。しかしながら上記公報に記載の補償板は、従 来の補償板よりは視野角依存性が改良されたものの、性 能的には満足できるものではなかった。この原因の一つ としては、TNおよびSTNなどの液晶セル、具体的に は液晶駆動セル内の液晶分子の配向がツイスト、すなわ ちねじれ構造を持つものであり、上記公報記載の補償板 を用いたとしても、該ねじれ構造による視角に対する影 響を完全には補償していなかったことをあげることがで き、更なる改良が望まれていた。

【0005】またSTNなどの複屈折モードを用いてい る表示方式では、カラー表示のために、ねじれネマチッ ク液晶性高分子フィルムやプラスチックシートを延伸し て得られる各種位相差フィルムなどを利用して、液晶セ ルに由来するねじれ構造のねじれ補償をしている。しか し、これらのねじれ補償のために設けられた各種フィル ムなどにおいても視角依存性の問題を解決することがで きていない状況にあり、液晶セルに由来するねじれ構造 と屈折率異方性のどちらをも同時に補償し得る補償素子 の開発が強く望まれていた。

[0006]

20

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 課題を解決した液晶性光学フィルムを提供することにあ り、さらに該液晶性光学フィルムから成る、液晶表示素 子用補償フィルムを提供することにある。詳しくは、液 晶ディスプレーの視角依存性を軽減するために、液晶セ ルに由来するねじれ構造と屈折率異方性のどちらをも同 時に補償し得ることが可能な補償フィルムを提供するこ とにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、液晶ディ スプレーの視角依存性を軽減するために、液晶セルの由 来するねじれ構造と屈折率異方性のどちらをも同時に補 償し得る光学フィルムを開発すべく鋭意検討した結果、 ディスコティック液晶をねじれ配向・固定化した新たな 液晶性光学フィルムの開発に成功し、さらに前記液晶性 光学フィルムが液晶ディスプレーの視角依存性の問題を 解消する優れた補償フィルムとなることを見いだし、遂 に本発明に到達した。

【0008】すなわち本発明の第1は、液晶状態におけ る液晶の配向形態を固定化したフィルムにおいて、該フ ィルムがディスコティック液晶性材料から形成され、該 ディスコティック液晶の配向形態が、ねじれ配向であ <u>り、かつディスコティック液晶のダイレク</u>ターとフィル <u>ム平面法線とがなす角度が、フィルムの厚さ方向に変化</u> した状態で固定化されたものであることを特徴とする液 晶性光学フィルムに関する。また本発明の第2は、ディ スコティック液晶性材料が、少なくとも1種の光学活性 isplay'89,336 (1989))、また、こ 50 な化合物を含有することを特徴とする上記第1に記載の

液晶性光学フィルムに関する。

【0009】また本発明の第3は、少なくとも1種の光学活性な化合物が、光学活性なディスコティック液晶性化合物であることを特徴とする上記第1乃至第2に記載の液晶性光学フィルムに関する。

[0010]

[0011]

【0012】また本発明の<u>第4は</u>、ディスコティック液晶のダイレクターとフィルム平面法線とがなす角度が、フィルムの上面と下面とで異なることを特徴とする上記 10第1乃至<u>第3</u>に記載の液晶性光学フィルムに関する。

【0013】また本発明の<u>第5は</u>、上記第1乃至<u>第4に</u> 記載の液晶性光学フィルムから成ることを特徴とする液 晶表示素子用補償フィルムに関する。

【0014】さらに本発明の<u>第6は</u>、上記<u>第5に</u>記載の 補償フィルムを1枚または複数枚備えたことを特徴とす る液晶表示装置に関する。

【0015】以下、本発明についてさらに詳しく説明す る。<u>以下では、本発明の液晶性光学フィルムの上位概念</u> に相当する液晶状態における液晶の配向形態を固定化し 20 たフィルムにおいて、該フィルムがディスコティック液 <u>晶性材料から形成され、該ディスコティック液晶の配向</u> 形態が、ねじれ配向である液晶性光学フィルムについて <u>も説明する。</u>一般にディスコチック液晶は,平面性の高 い円盤状の形をしたメソゲンを有する分子により発現さ れる液晶である。ディスコチック液晶の特徴は、液晶層 中の極微小領域における屈折率が負の一軸性を有するこ とであり、図1のように、ある平面内での屈折率が一定 であり(この方向の屈折率をnoとする)、その平面に 垂直な方向が光軸(以下ダイレクターと称する)であ り、該ダイレクター方向の屈折率をne としたとき, n o > ne となっている。この微小領域におけるダイレク ターを液晶相中でどのように配向させるかで, 得られる 構造体の屈折率特性、ひいては光学特性が決定される。 本発明の液晶性光学フィルムは、所望の光学特性に合わ せて配向形態の制御を行うことが可能である。

【0016】通常、液晶層全体にわたってダイレクターが同一方向を向いている場合、負の一軸性の構造物となり、従来の方法でディスコティック液晶を均一配向した場合には、通常、図2(a),(b)の構造をとる。図2の(a)は、ダイレクターが基板の法線にあることからホメオトロピック配向と呼ばれ、また(b)は、ダイレクターが基板法線から一定角度傾いたチルト配向は、レクターが基板法線から一定角度傾いたチルト配向は、図2(c)のようにフィルムの上面と下面とでフィルム平面法線とダイレクターとのなす角度が異なる配向形態も考えられる。この配向形態は、棒状の液晶分子では一般にハイブリッド配向という。

【0017】本発明の液晶性光学フィルムは、上記の如 50

きホメオトロピック配向、チルト配向または該配向形態 に基づく負の一軸性構造や、ハイブリッド配向とは異な る。つまりディスコティック液晶性材料を用い、該液晶 が液晶状態において形成した、ねじれ配向、つまりねじ れ構造を有する配向形態を、該配向形態を損なうことな く固定化されていることに最大の特徴がある。

6

【0018】本発明の液晶性光学フィルムは、一般にフ ィルム面に平行なある一平面をとれば、該平面に存在す るディスコティック液晶分子のダイレクターは全て同一 方向を向く。本発明で言うねじれ配向とは、該液晶分子 が液晶状態において形成したねじれ構造を意味し、その ねじれ構造とは、フィルムの厚さ方向に片方の面から他 方の面に向かって、ダイレクターのフィルム面内への投 影が単調増加的すなわち回転の方向を変えることなしに 回転する構造である。表現をかえて説明すれば、フィル ム面に平行な複数の平面において、任意の少なくとも二 つの平面をとると、各々の該平面に存在するディスコテ イック液晶分子の投影されたダイレクターの向きとが3 60度未満の場合に、該ダイレクターの向きが重ならな い二つの平面をフィルム内に有する構造を言う。なお前 記任意の二つの平面において、片方の面に存在するディ スコティック液晶分子のダイレクターの投影の向きと、 他方の面に存在するディスコティック液晶分子のダイレ クターの投影の向きとが360度以上異なる場合があ る。その際、ダイレクターの投影の向きが、任意の二つ の平面でもって重なる二つの平面をフィルム内に有する ことになる。具体的には、360度ねじれている場合、 任意の二つの平面においてそれぞれの投影されたダイレ クターの向きが重なることとなる。このように360度 以上のねじれがフィルム内の二つの任意の平面間でもっ て存在し、その結果ダイレクターの投影の向きが重なる 場合も、任意の回転軸でもってダイレクターの投影の向 きが回転、つまり360度以上ねじれた結果、そのダイ レクターの投影の向きが重なるのであるから、二つの平 面間において、それぞれのダイレクターの投影の向きが 360度以上ある場合においても、本発明で言うねじれ 構造に相当する。ここで、ダイレクターが360度回転 するに要する膜厚を1ピッチとする。

【0019】さらに本発明においては、液晶状態でねじれを持つと同時にディスコティック液晶のダイレクターとフィルム平面法線とのなす角度(以後、チルト角と称する)がフィルムの厚さ方向で変化した配向形態でもって固定化することができる。なお本発明では、ねじれの見かけの回転軸はフィルム平面法線方向にとり、ダイレクターのフィルム面内方向の成分の回転角によりねじれ角を定義するが、チルト角が0.1度以内、好ましくは0.5度以内、さらに好ましくは1度以内であるような、ダイレクターがほぼフィルム平面法線方向を向く部分については、そのねじれ角は無いものと見なす。

【0020】また本発明のねじれ配向において、ダイレ

クターのフィルム面内成分の向きはフィルムの厚さ方向 の移動に伴い、通常単調増加的に変化するが、ダイレク ターがほぼフィルム法線を向く部分がフィルム内部に存 在する場合には、その部分において単調増加的でなく変 化する場合もあり得る。この一例を図3に示した。図3 では、ダイレクターの方向を矢印で示している。また図 3-Aは、ダイレクターをフィルムの斜め横から見た図 を表す。さらに図3-Bは、図3-Aのダイレクターを フィルムの真上から投影した図である。図3-Bの矢印 は、ダイレクターのフィルム面内成分の方向を表す。図 10 3においては、(1)から数字の順にフィルムの厚さ方 向に単調増加的に変化する。ところが (4) において は、チルト角が0度となり、ダイレクターがフィルム平 面方向、すなわち真上を向く。従って(4)を通って (5) に至る部分においてはダイレクターのフィルム面 内成分が存在しない部分を含むために該成分の向きの変 化が単調増加的でなくなる。(5)より以降は、チルト 角を増大させながら再び単調増加的に変化する、といっ た場合である。このときのねじれ角は、単調増加的な変

【0021】本発明の液晶性光学フィルムのねじれ角は、チルト角またはディスコティック液晶の固有複屈折率などにより影響を受けるため一概には言えないが、通常1~500度、好ましくは5~300度の範囲である。

化ではない部分の前後の単調増加的変化部分の合計をも

ってこれを定義する。

【0022】次に、本発明の液晶性光学フィルムが形成することが可能なねじれ配向の配向形態の例を図4(構造A)から図8(構造E)に示す。但し、該液晶性光学フィルムの配向形態は、これらの配向形態に限定されるものではない。なお図4から図8の図中、コイン状のものがディスコティック液晶性化合物の一分子を意味する。図4(構造A)は、面内方向を向いたダイレクターがねじれ構造をとったものである。図5(構造B)は、一定のチルト角をもって傾いたものであり、(構造A)はチルト角が90度である特別な場合とみなすこともできる。

【0023】図6(構造C)は、(構造B)における見かけの回転軸が基板法線から、あたかも一定角度傾いたものを図示しているが、本発明のねじれ構造における回転軸はフィルム平面法線方向にある。したがって、(構造C)では、チルト角が厚み方向で変化した配向、すなわち以下に示す図7(構造D)または図8(構造E)の特別な場合と見なす。

【0024】 (構造D) は、チルト角がフィルムの厚さ方向で変化したものであるが、この場合はフィルム上面と下面のチルト角が同一の場合を図示したものである。一方、フィルム上面と下面とのチルト角は必ずしも同一である必要はなく、 (構造E) に示すように異なる値をとることもできる。

【0025】以上の配向形態の場合において、チルト角、すなわちディスコティック液晶性化合物が有するダイレクターとフィルム平面法線とのなす角度は0~90度の任意の値をとることができ、フィルムの厚さ方向全体にわたって0度であることはできないが、厚さ方向の一部においては、上記にも説明したように0度であることはできる。

【0026】次に、本発明に用いるディスコティック液晶性材料について説明する。該材料は、ディスコティック液晶性化合物単独、または、少なくとも一種の該液晶性化合物を含有する混合物から成る。

【0027】ディスコティック液晶はC. Destra deらにより、その分子の配向秩序によってND相(d iscotic nematic phase), Dh o相(hexagonal ordered colu mnar phase)、Dhd相(hexagona l disordered columnar pha se)、Drd相(rectangular diso rdered columnar phase), Do b相 (oblique columnar phas e) のように分類されている (C. Destrade et al., Mol. Cryst. Liq. Crys t., 106, 121 (1984))。さらに、上記N D相に光学活性物質を添加することでねじれを導入した ND[®] 相の存在も示されている (C. Destrade et al., Phys. Lett., 79A, 18 9 (1980))。

【0028】本発明において、これらの分子配向秩序は 特に限定されないが、配向の容易さの観点から、ND* 相を少なくとも有する材料が好ましく、特に好ましいの はND^{*}相を唯一の液晶相として有するものである。本 発明に用いられるディスコティック液晶性材料は、その 液晶状態における配向形態を損なうことなく固定化する ために、固定化時に液晶相から結晶相への転移が起こら ないものが好ましい。またフィルムを形成した際、使用 条件下で配向形態が保たれ、且つ、固体と同様に取り扱 いができるものが望ましい。さらに、本発明で言う固定 化した、という状態は、液晶構造がアモルファスなガラ ス状態で凍結された状態が最も典型的、且つ好ましい態 様ではあるが、それだけに限定されるものではなく、本 発明の液晶性光学フィルムの使用条件下、具体的には、 通常0~50℃、より過酷な条件下では-30~70℃ の温度範囲において、該フィルムに流動性が無く、また 外場や外力によって配向形態に変化を生じさせることな く、固定化された配向形態を安定に保ち続けることがで きる伏態を指すものである。以上のことより、本発明に 用いられるディスコティック液晶性材料としては、以下 のいずれかの性質を持つものが好ましい。

【0029】 ②液晶状態より低温域にガラス相のみを有し、結晶相を持たない。すなわち液晶状態より温度を下

50

げていくとガラス状態で固定化される。

②液晶状態より低温域に結晶相を有し、さらに結晶相よ り低温域にガラス相を有するものであって、液晶状態か ら温度を下げたとき、結晶相が出現せず(結晶相が過冷 却する場合、または昇温時のみに結晶化を起こすモノト ロピックな場合)、液晶状態より温度を下げていくとガ ラス状態で固定化される。

③液晶状態より低温域に結晶相を有するが、さらに低温 域においては、明瞭なガラス転移を示さないものであっ て、液晶状態から温度を下げたとき、結晶相が出現しな い(結晶相が過冷却する場合、または昇温時にのみに結 晶化を起こすモノトロピックな場合)。この場合、融点 (固定化した後、再度高温に加熱したときに観測され る) よりさらに低い温度では、分子の流動性がきわめて 制限された状況にある、実用上固体の材料とみなせる。 砂液晶状態より低温域で、昇温過程および降温過程にお いても明瞭な結晶への転移もガラス状態への転移も観測 されないが、液晶状態における配向形態を固定化した 際、本フィルムの使用温度範囲内で流動性が全くなく、 且つ、ズリなどの外力や外場を加えても配向形態が変化 20 しない。

【**0030】上記のうち、より好ましいものは①**および ②のいずれかの場合であり、最も好ましいのは①の性質 を持ったものを用いる場合である。なお、3および4の いずれの場合でも実用上差し支えなく用いることができ るが、液晶性光学フィルムの使用条件下で配向の乱れが 起こる可能性がないことを注意深く確かめる必要性があ る。具体的には、通常0~50℃の温度範囲において、 例えばズリなどを強制的に加え、配向形態に乱れが生じ なければ特に問題はない。ズリなどによって配向形態に 乱れが生じた場合、本来の光学性能は失われ、その後如 何なる処理を施してももとの配向形態に戻すことは困難 であり、実際の使用において大きな問題となる。

【0031】本発明に用いるディスコティック液晶性材 料は、上記のいずれかの性質を持つと同時に、均一な欠 陥のない配向のために、良好なドメイン合一性を示すも のが望ましい。ドメインの合一性が悪い場合には、得ら れる構造がポリドメインとなり、ドメイン同士の境界に 配向欠陥が生じ、光を散乱するようになる。また、フィ ルムの透過率低下にもつなかるので望ましくない。

【0032】次に、該液晶性材料となり得るディスコテ イック液晶性化合物について説明する。該化合物の具体 的な構造は、主にディスコティック液晶相を発現させる のに必須の円盤状の中心部分(ディスコゲン)と、液晶 相を安定化するために必要な置換基とで構成される。該 置換基は、一官能性のものが好ましく用いられるが、こ 官能性のものを用いてディスコゲン同士を一部連結さ せ、オリゴマー化またはポリマー化させたりして得られ る化合物も本発明の材料として好ましく用いることがで きる。この時二官能性の置換基を用いてディスコゲンが 50 主鎖に存在するポリマーとしても良いし、あるいはポリ アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリシロキサンのよう なポリマー、好ましくは非晶性ポリマーの側鎖として存

10

在させても良い。

【0033】具体的に本発明に用いることができるディ スコティック液晶性化合物の構造について説明する。一 般に本発明に用いられるディスコティック液晶性化合物 は、図9の概念図のような形状をとる。なお、図9はあ くまでも概念図であり、本発明はこれにより何ら制限さ れるものではない。図9において(A)は一官能性の置 換基のみを持つディスコティック液晶性化合物の一般的 構造であり、(B)は二官能性の置換基により二個のデ ィスコゲンが結合した構造のものである。

【0034】本発明では、少なくとも1種の光学活性な 化合物、好ましくは光学活性なディスコティック液晶性 化合物を該材料中に含有する、または少なくとも1種の 光学活性なディスコティック液晶性化合物から成る該材 料でもって本発明の液晶性光学フィルムを得る。光学活 性な化合物または光学活性なディスコティック液晶性化 合物において、鏡像体のいずれを該材料中に添加する、 または該材料として用いるかは、所望の光学特性によっ て決定されるが、一般に逆の立体配置を持つ鏡像体を用 いると液晶相のねじれの向きを逆にできる。本発明にお いて光学活性な化合物は、光学活性であって液晶相にね じれを誘起することができるものであればいずれも使用 することができるが、相溶性の観点から使用するディス コティック液晶と同様の液晶性を持つ化合物であること が望ましく、より具体的にはディスコティック液晶性化 合物において、ディスコゲンに結合した複数の置換基部 分の一部、あるいは全部を光学活性な置換基で置き換え た光学活性なディスコティック液晶性化合物が好まし い。なお、置換基の一部に光学活性でない(以下、「ア キラル」と言う語をこの意味で用いる) 基を含有した該 液晶性化合物を用いることも可能であるし、また全部の 置換基がアキラルなディスコティック液晶性化合物と少 なくとも一つの光学活性な置換基が結合した光学活性な ディスコティック液晶性化合物との混合物であっても使 用することが可能である。

【0035】本発明において用いられるアキラルなディ スコティック液晶性化合物および光学活性なディスコテ ィック液晶性化合物を構成する、ディスコゲンと成りう る化合物は、平面註に優れた分子構造を持つ化合物であ り、一般に芳香環を持ち、置換基結合部位(以下、置換 部位と略す)を3個以上、好ましくは6個以上有する化 合物である。次に、具体的な置換基の構造について述べ る。本発明に使用できる光学活性な一官能性の置換基 は、一般に炭素数3~30、好ましくは炭素数3~20 の置換基であり、必ずしも含まれる不斉中心の数が1個 に限られることはなく2個以上の不斉中心を持つ置換基 も用いることができる。具体的には次に示される置換基

を例示することができる(これらを例示1と称する)。

【0036】1-メチルプロピル基、1-メチルブチル

基、2-メチルブチル基、1-メチルペンチル基、2-

メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、1-メチル

ヘキシル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシ ル基、4-メチルヘキシル基、1-メチルヘプチル基、 2-メチルヘプチル基、3-メチルヘプチル基、4-メ チルヘプチル基、5-メチルヘプチル基、1-メチルオ クチル基、2-メチルオクチル基、3-メチルオクチル 基、4-メチルオクチル基、5-メチルオクチル基、6 ーメチルオクチル基、1ーメチルノニル基、2ーメチル ノニル基、3-メチルノニル基、4-メチルノニル基、 5-メチルノニル基、6-メチルノニル基、7-メチル ノニル基、1-メチルデシル基、2-メチルデシル基、 1-メチルウンデシル基、2-メチルウンデシル基、1 ーメチルドデシル基、2-メチルドデシル基、1-エチ ルブチル基、1-エチルペンチル基、2-エチルペンチ ル基、1-エチルヘキシル基、2-エチルヘキシル基、 1-エチルヘプチル基、1-エチルオクチル基、1-エ チルノニル基、1-エチルデシル基、1-エチルウンデ シル基、1, 2-ジメチルプロピル基、1, 2-ジメチ ルブチル基、1, 2-ジメチルペンチル基、1, 2-ジ メチルヘキシル基、1,2-ジメチルヘプチル基、1, 2-ジメチルオクチル基、1,2-ジメチルノニル基、 1, 2-ジメチルデシル基、1, 2-ジメチルウンデシ ル基、1,2-ジメチルドデシル基、グリシジル基、1 ートリフルオロメチルエチル基、1ートリフルオロメチ ルプロピル基、1-トリフルオロメチルブチル基、1-トリフルオロメチルペンチル基、1-トリフルオロメチ ルヘキシル基、1-トリフルオロメチルヘプチル基、1 ートリフルオロメチルオクチル基、1-トリフルオロメ チルノニル基、1-トリフルオロメチルデシル基、1-フェニルー2、2、2、-トリフルオロエチル基、 2, -トリフルオロエチル基、1-フルオロメチルエチ ル基、1-フルオロメチルプロピル基、2-フルオロメ チルプロピル基、1-フルオロメチルブチル基、1-ク ロロメチルエチル基、1-クロロメチルプロピル基、2 - クロロメチルプロピル基、1 - クロロメチルブチル 基、1-フェニルエチル基、1-フェニルプロピル基、 2-メトキシプロピル基、2-メトキシペンチル基、2 -エトキシプロピル基、2-エトキシブチル基、2-ブ トキシプロピル基、1-(メトキシメチル)エチル基、 1- (エトキシメチル) エチル基、1- (プロポキシエ チル) エチル基、2-メトキシ-3-ペンチルオキシプ ロピル基、2-メトキシー3-ヘキシルオキシプロピル 基、2-メトキシー3-ヘプチルオキシプロピル基、2 ーメトキシー3ーオクチルオキシプロピル基、2ーメト キシ-3-ノニルオキシプロピル基、2-メトキシ-3 ーデシルオキシプロピル基、2-メトキシ-3-ウンデ 50 シルオキシプロピル基、2ーメトキシー3ードデシルオキシプロピル基、2ーメトキシー1ーエトキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ープロポキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーペンチルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーペンチルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーペプチルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーオクチルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーノニルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーデシルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーデシルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー1ーウンデシルオキシメチルエチル基、2ーメトキシー4ーメチルペンチル基、2ーエトキシー3ーメチルペンチル

基、2-エトキシー4-メチルペンチル基、2-プロポ

キシー3-メチルペンチル基、2-プロポキシ-4-メ

チルペンチル基、2-ブトキシー3-メチルペンチル

12

【0038】2-ブトキシ-4-メチルペンチル基、2 -エトキシ-3-フェニルプロピル基、2-プロポキシ -3-フェニルプロピル基、2-ブトキシ-3-フェニ ルプロピル基、2-ペンチルオキシ-3-フェニルプロ ピル基、2-ヘキシルオキシ-3-フェニルプロピル 基、2-ヘプチルオキシ-3-フェニルプロピル基、2 -メトキシ-2-フェニルエチル基、2-エトキシ-2 ーフェニルエチル基、2-プロポキシー2-フェニルエ チル基、2-ブトキシ-2-フェニルエチル基、2-ペ ンチルオキシー2-フェニルエチル基、2-エキシルオ キシー2-フェニルエチル基、2-メトキシ-2-(4 ーペンチルオキシフェニル) エチル基、2-メトキシー 2-(4-ヘキシルオキシフェニル)エチル基、2-メ トキシー2-(4-ヘプチルオキシフェニル) エチル 基、2-メチルシクロペンチル基、3-メチルシクロペ ンチル基、2ーメチルシクロヘキシル基、3ーメチルシ クロヘキシル基、2-フェニルシクロヘキシル基、3-フェニルシクロヘキシル基、メンチル基、イソメンチル 基、2-(ペンテン-2-イル)-5-メチルシクロへ キシル基、4,4-ジメチルテトラヒドロフラー2-ノ ンー3ーイル基、ノルボルナンー2ーイル基、ノルボル ナンー7ーイル基、ボルネニル基、テルピネニル基、コ レステリル基、2-(1-メトキシ-1-メチルエチ 40 ル) - 5 - メチルシクロヘキシル基、テトラヒドロフラ ン-2-イル基、テトラヒドロフラン-3-イル基、テ トラヒドロピランー2ーイル基、テトラヒドロピランー 3-イル基、2-メトキシシクロヘキシル基、3-メト キシシクロヘキシル基、2-メトキシシクロペンチル 基、3-メトキシシクロペンチル基。

能性の置換基は一般に炭素数3~30、好ましくは、炭素数3~20の置換基であり、具体的な例を次に示す (これらを例示2と称する)。

【0039】一方、本発明に使用できる光学活性な二官

【0040】メチルエタン-1,2-ジイル基、1,2

- ジメチルエタン-1, 2-ジイル基、フェニルエタン -1, 2-ジイル基、メトキシメチルエタン-1, 2-ジイル基、エトキシメチルエタン-1, 2-ジイル基、 プロポキシメチルエタン-1,2-ジイル基、ブトキシ メチルエタン-1, 2-ジイル基、ペンチルオキシメチ ルエタン-1, 2-ジイル基、ヘキシルオキシメチルエ タン-1, 2-ジイル基、2-メチルブタン-1, 4-ジイル基、2-フェニルブタン-1, 4-ジイル基、2 -ベンジルブタン-1, 4-ジイル基、2-エチルブタ $\nu-1$, 4-ジイル基、1, $2-ジメチルブタ<math>\nu-1$, 4-ジイル基、2、3-ジメチルブタン-1、4-ジイ ル基、2-メトキシブタン-1, 4-ジイル基、2-エ トキシブタン-1, 4-ジイル基、2-プロポキシブタ ンー1, 4-ジイル基、2-ブトキシブタン-1, 4-ジイル基、2,3,ジメトキシブタン-1,4-ジイル 基、2、3-ジエトキシブタン-1、4-ジイル基、 2, 3-ジベンジロキシブタン-1, 4-ジイル基、1 ーメチルヘキサン-1,6-ジイル基、2-メチルヘキ サン-1, 6-ジイル基、3-メチルヘキサン-1, 6- ジイル基、シクロペンタン-1,2-ジイル基、シク ロペンタン-1, 3-ジイル基、シクロヘキサン-1, 2-ジイル基、シクロヘキサン-1, 3-ジイル基、シ クロヘプタン-1, 2-ジイル基、シクロオクタン-1, 2-ジイル基、1, 2, 2-トリメチルシクロペン タン-1, 3-ジメチル基、ノルボルナン-2, 3-ジ イル基、ノルボルナン-2,5-ジイル基、ノルボルナ ン-2,6-ジイル基、5-ノルボルナンメチル-(2, α) -ジイル基。

【0041】次に本発明に用いられるディスコティック 液晶性化合物および光学活性なディスコティック液晶性 30 化合物の製造方法、つまり置換基と成りうる化合物とデ ィスコゲンと成りうる化合物における置換部位との結合 方法について述べる。例示1または例示2に示された置 換基をディスコゲンと成りうる化合物の結合部位と結合 させる手段については特に制限されるものではないが、 例えばディスコゲンと成りうる化合物の置換部位が、ヒ ドロキシル基またはメルカプト基を持つ場合、該部位を アルキル化することによって、エーテル結合またはスル フィド結合を形成せしめて、ディスコゲンと成りうる化 合物と置換基と成りうる化合物とを結合させる。この場 40 合には、例示1に記載した置換基を有するトシレート、 メシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイドもしく はアイオダイド化合物など、または例示2に記載した置 換基を有するジトシレート、ジメシレート、ジベンゼン スルホネート、ジブロマイドもしくはジアイオダイド化 合物などを塩基性化合物の存在下、または非存在下にお いて、ディスコゲンと成りうる化合物の置換部位である アルコキサイド、フェノキサイド、チオアルコキサイド またはチオフェノキサイドと縮合せしめる方法を挙げる ことができる。この際に用いられるヒドロキシル基また 50 ニルアセトキシ)トルクセン、2,3,7,8,12,

はメルカプト基を持つディスコゲンとなりうる化合物の 具体例としては、

14

【0042】2, 3, 6, 7, 10, 11ーヘキサヒド ロキシトリフェニレン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサメルカプトトリフェニレン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタヒドロキシジベンゾ [f g, op] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 1 2, 13-オクタメルカプトジベンゾ [fg, op] ナ フタセン、1, 3, 5-トリヒドロキシベンゼン、1, 3, 5-トリメルカプトベンゼン、2, 3, 7, 8, 1 2, 13-ヘキサヒドロキシトルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサメルカプトトルクセン、2、 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサヒドロキシトリオキサ トルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサメル カプトトリオキサトルクセン、1, 2, 3, 5, 6, 7 ーヘキサヒドロキシアントラキノン、1,2,3,5, 6-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-4H-ピランー 4ーイリデン) -2, 6ービス (4ーヒドロキシフェニ ル) - 4 H - ピラン、4 - (2, 6 - ビス (4 - メルカ \mathcal{I} トフェニル) -4H-ピラン-4-イリデン) -2. 6-ビス(4-メルカプトフェニル)-4H-ピラン、 1, 3, 6, 8ーテトラヒドロキシピラン、1, 3, 6,8-テトラメルカプトピラン、2,3,6,7,1 0, 11-ヘキサキス (4-ヒドロキシベンゼン-1-イルカルボキシ) トリフェニレン、2, 3, 6, 7, 1 0, 11-ヘキサキス (6-ヒドロキシナフタレン-2 ーイルカルボキシ) トリフェニレン、2,3,6,7, 10, 11-ヘキサキス(4'-ヒドロキシ[1, 1' ービフェニル] -4-イルカルボキシ) トリフェニレ ン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサキス (4-ヒ ドロキシフェニルアセトキシ)トリフェニレン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサキス (4-ヒドロキシ フェニルプロペノイロキシ)トリフェニレン、1,3, 5-トリス (4-ヒドロキシベンゼン-1-イルカルボ キシ) ベンゼン、1,3,5-トリス(6-ヒドロキシ ナフタレンー2ーイルカルボキシ)ベンゼン、1,3, 5-トリス (4'-ヒドロキシ [1, 1'-ビフェニ ル] -4-イルカルボキシ) ベンゼン、1,3,5-ト リス(4-ヒドロキシフェニルアセトキシ)ベンゼン、 【0043】1,3,5-トリス(4-ヒドロキシフェ ニルプロペノイロキシ) ベンゼン、2, 3, 7, 8, 1 2, 13-ヘキサキス (4-ヒドロキシベンゼン-1-イルカルボキシ)トルクセン、2,3,7,8,12, 13-ヘキサキス (6-ヒドロキシナフタレン-2-イ ルカルボキシ) トルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 1 3-ヘキサキス (4'-ヒドロキシ [1, 1'-ビフェ ニル] -4-イルカルボキシ) トルクセン、2,3, 7, 8, 12, 13-ヘキサキス (4-ヒドロキシフェ

スコティック液晶性化合物、つまりアキラルな基のみからなるディスコティック液晶性化合物と光学活性基を含有する該液晶性化合物とを混合したディスコティック液晶性材料を使用することができる。上記光学活性ではないディスコティック液晶性化合物を構成するアキラルな

【0046】本発明においては、光学活性ではないディ

16

置換基のうち一官能性の基は炭素数1~30、好ましくは炭素数1~20の脂肪族基、脂環族基、または芳香族 基などを持つものであり、通常トシレート、メシレー

ト、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、またはアイオダイド化合物として、ディスコゲンと成りうる化合物の置換部位との結合形成反応に供給される。

【0047】具体的には、メチルトシレート、エチルトシレート、プロピルトシレート、イソプロピルトシレート、ベンチルトシレート、ヘキシルトシレート、ヘプチルトシレート、トシレート、ウンデシルトシレート、ドデシルトシレート、ウンデシルトシレート、ドデシルトシレート、トリデシルトシレート、またはこれらに対応するメシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、あるいはアイオダイド化合物などを挙げることができる。

【0048】また、アキラルな炭素数2~30、好まし くは炭素数2~20の二官能性の基を用いることもで き、これも通常トシレート、メシレート、ベンゼンスル ホネート、ブロマイド、あるいはアイオダイド化合物と して結合形成反応に例えばアルキルトシレート、アリー ルトシレートなどが供給される。具体的には、エタンー 1, 2-ジトシレート、プロパン-1, 3-ジトシレー ト、ブタンー1, 4ージトシレート、ペンタンー1, 5 ージトシレート、ヘキサンー1,6-ジトシレート、ヘ プタンー1, 7ージトシレート、オクタンー1, 8ージ トシレート、ノナンー1、9-ジトシレート、デカンー 1, 10-ジトシレート、ウンデカン-1, 11-ジト シレート、ドデカンー1,12-ジトシレート、ベンゼ ン-1, 4-ジトシレート、ベンゼン-1, 4-ジメチ ν - α , α '-ジトシレート、シクロヘキサン-1, 4 対応するジメシレート、ビスベンゼンスルホネート、ジ ブロマイド、もしくはジアイオダイドなどを例示するこ とができる。

【0049】次に、ディスコゲンと成りうる化合物の置換部位が、ヒドロキシル基またはメルカプト基を持つ場合、光学活性なカルボン酸またはその機能性誘導体とのエステル結合を形成させることで本発明に用いることのできる光学活性なディスコティック液晶性化合物を製造することができる。その方法は特に制限されないが、例えは、置換部位に低級脂肪酸エステルを有するディスコゲンと成りうる化合物または、ディスコゲンと成りうる化合物または、ディスコゲンと成りうる化合物の置換部位のヒドロキシル基、若しくはメルカプ

13-ヘキサキス (4-ヒドロキシフェニルプロペノイ ロキシ) トルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘ キサキス (4-ヒドロキシベンゼン-1-イルカルボキ シ) トリオキサトルクセン、2、3、7、8、12、1 3-ヘキサキス (6-ヒドロキシナフタレン-2-イル カルボキシ) トリオキサトルクセン、2,3,7,8, 12, 13-ヘキサキス (4'-ヒドロキシ [1, 1' ービフェニル] -4-イルカルボキシ) トリオキサトル クセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサキス (4 ーヒドロキシフェニルアセトキシ) トリオキサトルクセ ν , 2, 3, 7, 8, 12, 13- α + ψ + χ (4- ψ ドロキシフェニルプロペノイロキシ) トリオキサトルク セン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13ス (4-ヒドロキシベンゼン-1-イルカルボキシ) ジ ベンゾ [f g, o p] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキス (6-ヒドロキシナフ タレン-2-イルカルボキシ) ジベンゾ [fg. op] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13ーオ クタキス (4'-ヒドロキシ [1, 1'-ビフェニル] -4-イルカルボキシ) ジベンゾ [fg, op] ナフタ セン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキ ス(4-ヒドロキシフェニルアセトキシ)ジベンゾ[f g, op] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 1 2, 13-オクタキス(4-ヒドロキシフェニルプロペ ノイロキシ)ジベンゾ [fg, op] ナフタセンなどを 挙げることができる。

【0044】これらの中で好ましくは、2, 3, 6, 7, 10, 11-へキサヒドロキシトリフェニレン、2, 3, 6, 7, 10, 11-へキサメルカプトトリフェニレン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタヒドロキシジベング [fg, op] ナフタセン、1, 3, 5-トリヒドロキシベンゼン、1, 3, 5-トリメルカプトベンゼン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサヒドロキシトルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサヒドロキシトリオキサトルクセン、1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロキシアントラキノン、4-(2, 6-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -4H-ピラン-4-7リデン) -2, 6-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -4H-ピランである。

【0045】上記の結合方法を用いる場合、光学活性な 40 (ジ)トシレート、(ジ)ブロマイド、あるいは(ジ)アイオダイド化合物は、1種または複数の混合物として、本発明に用いることが可能なディスコティック液晶性化合物の調製に使用することもできる。また必要であれば、アキラルな基の(ジ)トシレート、(ジ)メシレート、(ジ)ベンゼンスルホネート、(ジ)ブロマイド、(ジ)アイオダイド化合物との混合物を用いてアルキル化せしめ、該ディスコティック液晶性化合物を得ることもできる。 50

ト基をアセチル化などにより低級脂肪酸とのエステルに変換して得られた該化合物に対し、適当な光学活性なカルボン酸化合物およびその機能性誘導体とのエステル交換により、光学活性な基を導入することができる。また、別の方法として光学活性なカルボン酸またはその機能性誘導体をクロライド、酸無水物などに変換後、または例えばパラトルエンスルホン酸クロライド、ジシクロヘキシルカルボジイミドなどのカルボン酸を活性化できる試剤の存在下、ヒドロキシル基若しくはメルカプト基を置換部位として持つディスコゲンとなりうる化合物と

【0050】上記の方法において用いることができるヒドロキシル基、またはメルカプト基を置換部位として持つディスコゲンと成りうる化合物の例としては先に例示したものを挙げることができる。

エステル形成し、所望のディスコティック液晶性化合物

を得ることもできる。

【0051】また置換部位に低級脂肪酸エステルを持つ ディスコゲンと成りうる化合物の具体例としては、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセトキシトリフェニ レン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセチルチ 20 オトリフェニレン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 1 3-オクタアセトキシジベンゾ [fg, op] ナフタセ ン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13ーオクタアセ チルチオジベンゾ [fg, op] ナフタセン、1, 3, 5ートリアセトキシベンゼン、1,3,5ートリアセチ ルチオベンゼン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサ アセトキシトルクセン、2,3,7,8,12,13-ヘキサアセチルチオトルクセン、2, 3, 7, 8, 1 2, 13-ヘキサアセトキシトリオキサトルクセン、 2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサアセチルチオトリ オキサトルクセン、1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサア セトキシアントラキノン、1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘ キサアセチルチオアントラキノン、4-(2,6-ビス (4-アセトキシフェニル) -4H-ピラン-4-イリ デン) -2, 6-ビス (4-アセトキシシフェニル) -4H-ピラン、4-(2,6-ビス(4-アセチルチオ フェニル) -4H-ピラン-4-イリデン) -2, 6-ビス (4-アセチルチオフェニル) -4H-ピラン、 1, 3, 6, 8-テトラアセトキシピラン、1, 3, 6, 8-テトラアセチルチオピラン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサキス(4-アセトキシベンゼン-1 ーイルカルボキシ)トリフェニレン、2,3,6,7, 10, 11-ヘキサキス(6-アセトキシナフタレンー 2-イルカルボキシ)トリフェニレン、2,3,6, 7, 10, 11-ヘキサキス (4' ~アセトキシ [1, 1'ービフェニル]ー4ーイルカルボキシ)トリフェニ レン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサキス (4-アセトキシフェニルアセトキシ)トリフェニレン、2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサキス (4-アセトキシ フェニルプロペノイロキシ)トリフェニレン、1,3,

5-トリス (4-アセトキシベンゼン-1-イルカルボキシ) ベンゼン、1,3,5-トリス (6-アセトキシナフタレン-2-イルカルボキシ) ベンゼン、1,3,5-トリス (4'-アセトキシ [1,1'-ビフェニル] -4-イルカルボキシ) ベンゼン、1,3,5-トリス (4-アセトキシフェニルアセトキシ) ベンゼン、1,3,5-トリス (4-アセトキシフェニルプロペノイロキシ) ベンゼン、2,3,7,8,12,13-ヘキサキス (4-アセトキシナフタレン-2-イルカルボキシ) トルクセン、2,3,7,8,12,13-ヘキサキス (4'-アセトキシナフタレン-2-イルカルボキシ)トルクセン、2,3,7,8,12,13-ヘキサキス (4'-アセトキシ[1,1'-ビフェニル] -4

18

-イルカルボキシ) トルクセン、2, 3, 7, 8, 1 2, 13-ヘキサキス(4-アセトキシフェニルアセト キシ) トルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキ サキス(4-アセトキシフェニルプロペノイロキシ) ト ルクセン、 【0052】2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサキス

(4-アセトキシベンゼン-1-イルカルボキシ)トリ オキサトルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキ サキス (6-アセトキシナフタレン-2-イルカルボキ シ) トリオキサトルクセン、2, 3, 7, 8, 12, 1 3-ヘキサキス (4'-アセトキシ [1, 1'-ビフェ ニル] -4-イルカルボキシ) トリオキサトルクセン、 2, 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサキス (4-アセト キシフェニルアセトキシ)トリオキサトルクセン、2. 3, 7, 8, 12, 13-ヘキサキス (4-アセトキシ フェニルプロペノイロキシ)トリオキサトルクセン、 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキス (4 ーアセトキシベンゼンー1ーイルカルボキシ)ジベンゾ [fg, op] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキス(6-アセトキシナフタレン-2-イルカルボキシ) ジベンゾ [fg, op] ナフタセ ン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキス (4'-アセトキシ[1, 1'-ビフェニル]-4-イ ルカルボキシ) ジベンゾ [fg, op] ナフタセン、 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタキス (4) ーアセトキシフェニルアセトキシ) ジベンゾ [fg, o p] ナフタセン、1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 -オクタキス(4-アセトキシフェニルプロペノイロキ シ) ジベンゾ [fg, op] ナフタセンなどを挙げるこ とができる。

【0053】これらの中で好ましくは、2,3,6,7,10,11-ヘキサアセトキシトリフェニレン、1,2,5,6,8,9,12,13-オクタアセトキシジベング [fg,op] ナフタセン、1,3,5-トリアセトキシベンゼン、2,3,7,8,12,13-ヘキサアセトキシトルクセン、2,3,7,8,12,50 13-ヘキサアセトキシトリオキサトルクセン、4-

(2,6-ビス(4-アセトキシフェニル)-4H-ピ ラン-4-イリデン)-2,6-ビス(4-アセトキシ シフェニル)-4H-ピランである。

【0054】またこの際、ディスコゲンとなりうる化合物の置換部位に存在する低級脂肪酸エステルとのエステル交換反応に使用できる光学活性なカルボン酸またはその機能性誘導体は、炭素数3~30、好ましくは炭素数3~20のカルボン酸またはその機能性誘導体であり、例えば前記に例示した一官能性置換基を有するカルボン酸またはその機能性誘導体を使用することが可能である。

【0055】具体的には、2ーメチル酪酸、2ーメチル ペンタン酸、3-メチルペンタン酸、2-メチルヘキサ ン酸、3-メチルヘキサン酸、4-メチルヘキサン酸、 2-メチルヘプタン酸、3-メチルヘプタン酸、4-メ チルヘプタン酸、5-メチルヘプタン酸、2-メチルオ クタン酸、3-メチルオクタン酸、4-メチルオクタン 酸、5-メチルオクタン酸、6-メチルオクタン酸、2 ーメチルノナン酸、3ーメチルノナン酸、4ーメチルノ ナン酸、5-メチルノナン酸、6-メチルノナン酸、7 -メチルノナン酸、2-メチルデカン酸、2-メチルウ ンデカン酸、2-メチルドデカン酸、2-エチルペンタ ン酸、2-エチルヘキサン酸、2-フルオロメチルプロ ピオン酸、2-クロロメチルプロピオン酸、2-メトキ シプロピオン酸、2-メトキシ酪酸、2-メトキシペン タン酸、2-エトキシプロピオン酸、2-エトキシ酪 酸、2-プトキシプロピオン酸、2-メトキシ-3-ペ ンチルオキシプロピオン酸、2-メトキシ-3-ヘキシ ルオキシプロピオン酸、2-メトキシー3-ヘプチルオ キシプロピオン酸、2-メトキシ-3-オクチルオキシ 30 プロピオン酸、2-メトキシー3-ノニルオキシプロピ オン酸、2-メトキシ-3-デシルオキシプロピオン 酸、2-メトキシ-3-ウンデシルオキシプロピオン 酸、2-メトキシ-3-ドデシルオキシプロピオン酸、 2-メトキシ-4-メチルペンタン酸、2-エトキシ-3-メチルペンタン酸、2-エトキシ-4-メチルペン タン酸、2-プロポキシー3-メチルペンタン酸、2-プロポキシー4-メチルペンタン酸、2-ブトキシー3 -メチルペンタン酸、2-ブトキシ-4-メチルペンタ ン酸、2-エトキシ-3-フェニルプロピオン酸、2-40 プロポキシー3-フェニルプロピオン酸、2-ブトキシ -3-フェニルプロピオン酸、2-ペンチルオキシ-3 ーフェニルプロピオン酸、2-ヘキシルオキシー3-フ ェニルプロピオン酸、2-ヘプチルオキシ-3-フェニ ルプロピオン酸、2-メトキシ-2-フェニル酢酸、2 -エトキシ-2-フェニル酢酸、2-プロポキシ-2-フェニル酢酸、2-ブトキシ-2-フェニル酢酸、2-ペンチルオキシー2-フェニル酢酸、2-エキシルオキ シー2-フェニル酢酸、2-メトキシー2-(4-ペン

ヘキシルオキシフェニル)酢酸、2-メトキシー2-(4-ヘプチルオキシフェニル)酢酸、

20

【0056】2-メチルシクロペンタンカルボン酸、3 -メチルシクロペンタンカルボン酸、2-メチルシクロ ヘキサンカルボン酸、3-メチルシクロヘキサンカルボ ン酸、2-フェニルシクロヘキサンカルボン酸、3-フ ェニルシクロヘキサンカルボン酸、2-(ペンテン-2 -イル)-5-メチルシクロヘキサンカルボン酸、4, 4-ジメチルテトラヒドロフラー2-ノン-3-カルボ ン酸、ノルボルナンー2ーカルボン酸、ノルボルナンー 7-カルボン酸、2-(1-メトキシ-1-メチルエチ ル) -5-メチルシクロヘキサンカルボン酸、テトラヒ ドロフラン-2-カルボン酸、テトラヒドロフラン-3 -カルボン酸、テトラヒドロピラン-2-カルボン酸、 テトラヒドロピラン-3-カルボン酸、2-メトキシシ クロヘキサンカルボン酸、3-メトキシシクロヘキサン カルボン酸、2ーメトキシシクロペンタンカルボン酸、 3-メトキシシクロペンタンカルボン酸などを例示でき る。

【0057】さらに、芳香族基を持つ光学活性なカルボ ン酸またはその機能性誘導体も本発明に用いるディスコ ティック液晶性化合物の製造に好適に用いられる。具体 的には、安息香酸、メトキシ安息香酸、エトキシ安息香 酸、プロポキシ安息香酸、イソプロポキシ安息香酸、ブ トキシ安息香酸、イソブトキシ安息香酸、 s e c ーブト キシ安息香酸、tertーブトキシ安息香酸、ペンチル オキシ安息香酸、ヘキシルオキシ安息香酸、ヘプチルオ キシ安息香酸、オキシルオキシ安息香酸、ノニルオキシ 安息香酸、デシルオキシ安息香酸、フルオロ安息香酸、 ジフルオロ安息香酸、トリフルオロメチル安息香酸、ク ロロ安息香酸、ジクロロ安息香酸、メチル安息香酸、エ チル安息香酸、プロピル安息香酸、イソプロピル安息香 酸、ブチル安息香酸、イソブチル安息香酸、sec-ブ チル安息香酸、、tert-ブチル安息香酸、ペンチル 安息香酸、ヘキシル安息香酸、ヘプチル安息香酸、オク チル安息香酸、ノニル安息香酸、デシル安息香酸、安息 香酸、ジメトキシ安息香酸、ジエトキシ安息香酸、ジプ ロポキシ安息香酸、ジイソプロポキシ安息香酸、ジブト キシ安息香酸、ジイソブトキシ安息香酸、ジペンチルオ キシ安息香酸、ジヘキシルオキシ安息香酸、ジヘプチル オキシ安息香酸、ジオキシルオキシ安息香酸、ジノニル オキシ安息香酸、ジデシルオキシ安息香酸、ジフルオロ 安息香酸、ジクロロ安息香酸、

ロメチル桂皮酸、クロロ桂皮酸、ブロモ桂皮酸、ニトロ 桂皮酸、ジメチルアミノ桂皮酸、メチル桂皮酸、エチル 桂皮酸、プロピル桂皮酸、イソプロピル桂皮酸、ブチル 桂皮酸、イソブチル桂皮酸、sec-ブチル桂皮酸、、 tertーブチル桂皮酸、ペンチル桂皮酸、ヘキシル桂 皮酸、ヘプチル桂皮酸、オクチル桂皮酸、ノニル桂皮 酸、デシル桂皮酸、フェニル酢酸、(メトキシ)フェニ ル酢酸、 (エトキシ) フェニル酢酸、 (プロポキシ) フ ェニル酢酸、(イソプロポキシ)フェニル酢酸、(ブト キシ)フェニル酢酸、(イソブトキシ)フェニル酢酸、 (sec-ブトキシ) フェニル酢酸、 (tert-ブト キシ)フェニル酢酸、(ペンチルオキシ)フェニル酢 酸、(ヘキシルオキシ)フェニル酢酸、(ヘプチルオキ シ)フェニル酢酸、(オキシルオキシ)フェニル酢酸、 (ノニルオキシ) フェニル酢酸、(デシルオキシ) フェ ニル酢酸、(フルオロ)フェニル酢酸、(トリフルオロ メチル)フェニル酢酸、(クロロ)フェニル酢酸、(ブ ロモ)フェニル酢酸、(ニトロ)フェニル酢酸、(ジメ チルアミノ)フェニル酢酸、(メチル)フェニル酢酸、 (エチル) フェニル酢酸、(プロピル) フェニル酢酸、 (イソプロピル) フェニル酢酸、 (ブチル) フェニル酢 酸、(イソブチル)フェニル酢酸、(sec-ブチル) フェニル酢酸、(tert-ブチル)フェニル酢酸、 (ペンチル)フェニル酢酸、(ヘキシル)フェニル酢 酸、(ヘプチル)フェニル酢酸、(オクチル)フェニル 酢酸、(ノニル)フェニル酢酸、(デシル)フェニル酢 酸、フェニル酪酸、フェニル吉草酸、フェニルヘキサン 酸、スチルベンカルボン酸、1-ナフトエ酸、2-ナフ トエ酸、[1,1'ービフェニル]-4-カルボン酸な どのカルボン酸の一個あるいは複数の水素が光学活性基 により置換されたカルボン酸またはその機能性誘導体で あるが、好ましくは、容易に入手可能であるなどの理由 から光学活性なアルコキシ基により置換された上記カル ボン酸またはその機能性誘導体を利用することが望まし い。

【0059】上記の芳香族基を持つ光学活性なカルボン酸またはその機能性誘導体は、その製造方法についての制限は特になく、市販されているものを利用するか、または公知の方法により製造することができる。最も入手が容易である光学活性なアルコキシ基により置換された40カルボン酸の一般的な製造方法について概説する。

【0060】これらの化合物は例えば、ヒドロキシカルボン酸のヒドロキシ基を光学活性な基によりアルキル化することによって得ることかできる。この時用いることができるヒドロキシカルボン酸の例としては、2ーヒドロキシ安息香酸、3ーヒドロキシ安息香酸、3ーメトキシー4ーヒドロキシ安息香酸、4ーメトキシー3ーヒドロキシ安息香酸、3ーメトキシー4,5ージヒドロキシ安息香酸、3ーメトキシー4,5ージヒドロキシ安息香

酸、4-メトキシー3,5-ジヒドロキシ安息香酸、3 ーヒドロキシー4, 5ージメトキシ安息香酸、4ーヒド ロキシー3,5ージメトキシ安息香酸、2-ヒドロキシ フェニル酢酸、3-ヒドロキシフェニル酢酸、4-ヒド ロキシフェニル酢酸、3、4-ジヒドロキシフェニル酢 酸、3,4,5-トリヒドロキシフェニル酢酸、3-メ トキシー4ーヒドロキシフェニル酢酸、4-メトキシー 3-ヒドロキシフェニル酢酸、3-メトキシ-4,5-ジヒドロキシフェニル酢酸、4-メトキシー3,5-ジ ヒドロキシフェニル酢酸、3-ヒドロキシー4,5-ジ メトキシフェニル酢酸、4-ヒドロキシ-3, 5-ジメ トキシフェニル酢酸、2-ヒドロキシ桂皮酸、3-ヒド ロキシ桂皮酸、4-ヒドロキシ桂皮酸、3,4-ジヒド ロキシ桂皮酸、3,4,5-トリヒドロキシ桂皮酸、3 ーメトキシー4ーヒドロキシ桂皮酸、4ーメトキシー3 ーヒドロキシ桂皮酸、3ーメトキシー4、5ージヒドロ キシ桂皮酸、4ーメトキシー3,5ージヒドロキシ桂皮 酸、3-ヒドロキシー4,5-ジメトキシ桂皮酸、4-ヒドロキシー3、5-ジメトキシ桂皮酸、6-ヒドロキ シー2ーナフトエ酸、3ーヒドロキシー2ーナフトエ 酸、4'-ヒドロキシー[1, 1'-ビフェニル]-4 ーカルボン酸、2ーヒドロキシー1ーナフトエ酸、4ー ヒドロキシー1ーナフトエ酸などを具体例として例示で

【0061】これらのヒドロキシカルボン酸のヒドロキ シル基を適当な光学活性な基を有する化合物によりアル キル化すれば本発明に用いることができるディスコティ ック液晶性化合物を製造する際に使用することが可能 な、芳香族基を持つカルボン酸誘導体を得ることができ る。アルキル化の方法としては、光学活性なアルキル基 を有するトシレート、メシレート、ベンゼンスルホネー ト、ブロマイドまたはアイオダイド化合物などを塩基の 存在下、ヒドロキシカルボン酸と反応させる方法(以後 Williamson法と称する)を例示することがで きる。この時用いることができる光学活性なアルキル基 を有するトシレート、メシレート、ベンゼンスルホネー ト、ブロマイド、アイオダイド化合物としては、例示1 あるいは例示2に示したような基を有する該化合物およ びその機能性誘導体を例示することかできる。いずれの 化合物およびその機能性誘導体も好適に用いることがで きるが、入手の容易さなどからトシレート、メシレート またはブロマイド、より好ましくはトシレートが用いら

【0062】一方、置換基と成りうる化合物において、ヒドロキシル基を2個以上持つヒドロキシカルボン酸を原料とする場合には、光学活性なトシレート、メシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、またはアイオダイド化合物とともにアキラルな基のトシレート、メシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、またはアイオダイド化合物とを共存させ、ヒドロキシ基の一部に

光学活性基、残りの部分にアキラルな基を導入した光学 活性なカルボン酸またはその機能性誘導体を得、これを 本発明に用いる液晶性化合物の製造に使用することも可 能である。この時使用できるアキラルな基のトシレー ト、メシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、 あるいはアイオダイド化合物などは、炭素数1~30、 好ましくは炭素数1~20の脂肪族基、脂環族基または 芳香族基を有する化合物またはその機能性誘導体であ る。代表例としてトシレート化合物を例示するならば、 メチルトシレート、エチルトシレート、プロピルトシレ 10 ート、イソプロピルトシレート、ブチルトシレート、イ ソブチルトシレート、ペンチルトシレート、ヘキシルト シレート、ヘプチルトシレート、オクチルトシレート、 ノニルトシレート、デシルトシレート、ウンデシルトシ レート、ドデシルトシレート、トリデシルトシレート、 テトラデシルトシレート、ベンジルトシレート、アリル トシレート、シクロヘキシルトシレートなどを挙げるこ とができる。

【0063】一方、ニトロ基、シアノ基、カルボキシル 基、など求電子置換基のオルトまたはパラ位にあるフル 20 オロ基、クロロ基、ニトロ基、などが求核置換反応を受 けやすいことを利用してアルコキサイドとの反応により 本発明の材料を構成するディスコティック液晶性化合物 を製造する際に用いることができる芳香族基を持つカル ボン酸誘導体を製造する方法(以後SNAェ方法と称す る) も利用することができる。この時用いることができ る芳香族化合物としては、2-フルオロベンゾニトリ ル、4-フルオロベンゾニトリル、2-ニトロベンゾニ トリル、4-ニトロベンゾニトリル、2-クロロベンゾ ニトリル、4ークロロベンゾニトリル、2, 4ージニト ロベンゾニトリル、3、4-ジニトロベンゾニトリル、 3-ニトロー4-フルオロベンゾニトリル、3-フルオ ロー4ーニトロベンゾニトリル、2ーニトロー4ークロ ロベンゾニトリル、4-フルオロ安息香酸、2-フルオ 口安息香酸、4ーニトロ安息香酸、2ーニトロ安息香 酸、4-フルオロ-3-ニトロ安息香酸、4-クロロ-3-ニトロ安息香酸、などを挙げることができる。この 時ニトリルが中間体として得られる場合には、該ニトリ ルを酸性反応条件下あるいはアルカリ性反応条件下公知 の方法で加水分解することにより、所望の光学活性なカ 40 ルボン酸またはその機能性誘導体を得ることができる。 また、ニトロ基を含有する光学活性なカルボン酸または その機能性誘導体が得られる場合にも、可視域に吸収を 持つなど不適当な性質がない限り本発明に用いることが できる。また必要であるならば、適当な方法により他の 置換基に変換しても何ら差し支えない。

【0064】SNAr法において用いることができるアルコキサイドの例としては、例示1に示す置換基を持つアルコキサイドを例示できる。これらは一般に例示1に示される置換基を持つアルコールをアルカリ金属または 50

有機アルカリ化合物など、具体的にはNa、K、 Bu Li、NaH、KH、 Bu OKなどと、必要であれば適当な溶媒中で反応させることにより得ることができる。この場合において用いることができるアルコールとしては例示1の置換基を有するアルコールおよび/またはその機能性誘導体を例示することができる。

【0065】以上の方法により得られる芳香族基を持つ カルボン酸誘導体の具体的構造について以下にさらに詳 しく述べる。安息香酸誘導体の場合、光学活性な基によ る置換位置は一般に2、3、4位のいずれの位置が置換 されたものも用いることができるが、製造の容易さなど から4置換体が最も好ましく用いることができる。その 具体的な化合物は例示1の置換基を有する安息香酸誘導 体を挙げることができる。

【0066】具体的には、4-(1-メチルプロポキ シ) 安息香酸、4-(1-メチルブトキシ) 安息香酸、 4- (1-メチルペンチルオキシ) 安息香酸、4- (1 -メチルヘキシルオキシ) 安息香酸、4-(1-メチル ヘプチルオキシ) 安息香酸、4-(1-メチルオクチル オキシ) 安息香酸、4-(2-メチルブトキシ) 安息香 酸、4-(2-メチルペンチルオキシ) 安息香酸、4-(2-メチルヘキシルオキシ) 安息香酸、4-(2-メ チルヘプチルオキシ) 安息香酸、4ーメンチルオキシ安 息香酸、4、5-ビス(1-メチルプロポキシ)安息香 酸、4,5-ビス(1-メチルブトキシ)安息香酸、 4, 5ービス(1ーメチルプロポキシ) -3ーメトキシ 安息香酸、4,5-ビス(1-メチルブトキシ)-3-メトキシ安息香酸、3,5-ビス(1-メチルプロポキ シ) 安息香酸、3,5-ビス(1-メチルブトキシ)安 息香酸、3,5-ビス(1-メチルプロポキシ)-4-メトキシ安息香酸、3,5-ビス(1-メチルブトキ シ) -4-メトキシ安息香酸、3,4,5-トリス(1 ーメチルプロポキシ) 安息香酸、3,4,5ートリス (1-メチルブトキシ) 安息香酸、3,4,5-トリス (1-メチルペンチルオキシ) 安息香酸、3,4,5-トリス(1-メチルヘキシルオキシ)安息香酸、3, 4, 5-トリス (1-メチルヘプチルオキシ) 安息香 酸、3,4,5-トリス(1-メチルオクチルオキシ) 安息香酸、3,4,5-トリス(2-メチルブトキシ) 安息香酸、3,4,5-トリス(2-メチルペンチルオ キシ)安息香酸、3,4,5-トリス(2-メチルヘキ シルオキシ) 安息香酸、3,4,5-トリス(2-メチ ルヘプチルオキシ)安息香酸などを例示できる。

【0067】フェニル酢酸誘導体の場合、光学活性基による置換位置は一般に2、3、4のいずれの位置が置換されたものも用いることができるが、製造の容易さなどから具体的には、4-(1-メチルプトキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸

(1-メチルヘキシルオキシ)フェニル酢酸、4-(1

26

-メチルヘプチルオキシ)フェニル酢酸、4-(1-メ チルオクチルオキシ)フェニル酢酸、4-(2-メチル ブトキシ) フェニル酢酸、4-(2-メチルペンチルオ キシ) フェニル酢酸、4-(2-メチルヘキシルオキ シ)フェニル酢酸、4-(2-メチルヘプチルオキシ) フェニル酢酸、4-メンチルオキシフェニル酢酸、4. 5-ビス (1-メチルプロポキシ) フェニル酢酸、4, 5-ビス (1-メチルブトキシ) フェニル酢酸、4、5 ビス(1-メチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、 4, 5-ビス(1-メチルヘキシルオキシ)フェニル酢 10 酸、4,5-ビス(1-メチルプロポキシ)-3-メト キシフェニル酢酸、4,5-ビス(1-メチルブトキ シ) - 3 - メトキシフェニル酢酸、4,5-ビス(1-メチルペンチルオキシ) -3-メトキシフェニル酢酸、 4, 5-ビス(1-メチルヘキシルオキシ)-3-メト キシフェニル酢酸、3,4,5-トリス(1-メチルプ ロポキシ)フェニル酢酸、3,4,5ートリス(1ーメ チルブトキシ)フェニル酢酸、3,4,5-トリス(1 ーメチルペンチルオキシ)フェニル酢酸、3,4,5-トリス(1-メチルヘキシルオキシ)フェニル酢酸、 3, 4, 5-トリス (1-メチルヘプチルオキシ) フェ ニル酢酸、3,4,5-トリス(1-メチルオクチルオ キシ)フェニル酢酸、3,4,5-トリス(2-メチル ブトキシ)フェニル酢酸などを例示できる。

【0068】桂皮酸誘導体の場合、光学活性基による置 換位置は一般に2、3、4のいずれの位置が置換された ものも用いることができるが、製造の容易さなどから4 置換体が最も好ましく用いることができ、具体的には、 4-(1-メチルプロポキシ) 桂皮酸、4-(1-メチ ルブトキシ) 桂皮酸、4-(1-メチルペンチルオキ シ)桂皮酸、4-(1-メチルヘキシルオキシ)桂皮 酸、4-(1-メチルヘプチルオキシ) 桂皮酸、4-(1-メチルオクチルオキシ) 桂皮酸、4-(2-メチ ルブトキシ) 桂皮酸、4-(2-メチルペンチルオキ シ) 桂皮酸、4-(2-メチルヘキシルオキシ) 桂皮 酸、4-(2-メチルヘプチルオキシ)桂皮酸、4-メ ンチルオキシ桂皮酸、4,5-ビス(1-メチルプロポ キシ) 桂皮酸、4,5-ビス(1-メチルブトキシ) 桂 皮酸、4,5ービス(1ーメチルペンチルオキシ)桂皮 酸、4,5-ビス(1-メチルヘキシルオキシ) 桂皮 酸、4,5-ビス(1-メチルヘプチルオキシ) 桂皮 酸、4,5-ビス(1-メチルオクチルオキシ) 桂皮 酸、4,5-ビス(1-メチルプロポキシ)-3-メト キシ桂皮酸、4, 5-ビス(1-メチルブトキシ)-3 -メトキシ桂皮酸、4,5-ビス(1-メチルペンチル オキシ) - 3 - メトキシ桂皮酸、3, 5 - ビス(1 - メ チルプロポキシ) 桂皮酸、3,5-ビス(1-メチルブ トキシ) 桂皮酸、3,5-ビス(1-メチルペンチルオ キシ) 桂皮酸、3,5-ビス(1-メチルヘキシルオキ シ) 桂皮酸、3,5-ビス(1-メチルヘプチルオキ

シ) 桂皮酸、3, 5-ビス (1-メチルオクチルオキ シ) 桂皮酸、3, 4, 5-トリス (1-メチルプロポキ シ) 桂皮酸、3, 4, 5-トリス (1-メチルプトキ シ) 桂皮酸、3, 4, 5-トリス (1-メチルペンチル オキシ) 桂皮酸、3,4,5-トリス(1-メチルヘキ シルオキシ) 桂皮酸、3, 4, 5-トリス (1-メチル ヘプチルオキシ)桂皮酸などを例示できる。

【0069】一方、ナフトエ酸誘導体としては、一般に 置換ナフトエ酸のどの異性体も好適に使用できるが、好 ましくはカルボン酸基はナフタレン環の2の位置にある ものが用いられ、置換基は6または7、好ましくは6の 位置にあるものが用いられる。具体的には、6-(1-メチルプロポキシ)-2-ナフトエ酸、6-(1-メチ ルブトキシ) -2-ナフトエ酸、6-(1-メチルペン チルオキシ) -2-ナフトエ酸、6-(1-メチルヘキ シルオキシ) -2-ナフトエ酸、6-(1-メチルヘプ チルオキシ) -2-ナフトエ酸、6-(1-メチルオク チルオキシ) -2-ナフトエ酸、6-(2-メチルブト キシ) -2-ナフトエ酸、6-(2-メチルペンチルオ キシ) -2-ナフトエ酸、6-(2-メチルヘキシルオ キシ) -2-ナフトエ酸、6-(2-メチルヘプチルオ キシ) -2-ナフトエ酸などを例示できる。

【0070】さらに、[1, 1'ービフェニル] カルボ ン酸誘導体としては、一般に置換[1,1'ービフェニ ル] カルボン酸のどの異性体も好適に使用できるが、好 ましくはカルボン酸基は[1,1'ービフェニル]基の 4の位置にあるものが用いられ、置換基は4'の位置に あるものが用いられる。

【0071】具体的には、4'-(1-メチルプロポキ 30 シ) - [1, 1'-ビフェニル] - 4 - カルボン酸、 4'-(1-メチルブトキシ)-[1, 1'-ビフェニ ル] -4-カルボン酸、4'-(1-メチルペンチルオ キシ) - [1, 1'ービフェニル] - 4 - カルボン酸、 4'-(1-メチルヘキシルオキシ)-[1, 1'-ビ フェニル] -4-カルボン酸、4'- (1-メチルヘプ チルオキシ) - [1, 1'-ビフェニル] - 4 - カルボ 1'-ビフェニル]-4-カルボン酸、4'-(2-メ チルブトキシ)-[1,1'-ビフェニル]-4-カル ボン酸、 $4' - (2 - \forall f \wedge \forall f \wedge$ 1'-ビフェニル]-4-カルボン酸、4'-(2-メ チルヘキシルオキシ)ー[1,1'ービフェニル]-4 -カルボン酸、4'-(2-メチルヘプチルオキシ)-[1, 1'ービフェニル] - 4 - カルボン酸などを例示 できる。

【0072】一方、モノカルボン酸だけではなくジカル ボン酸も好適に使用でき、その例として、メチルコハク 酸、2-ジメチルアミノコハク酸、2-メトキシコハク 酸、2-エトキシコハク酸、2-ベンジルコハク酸、2 50 ーフェニルコハク酸、2-(4-メトキシフェニルメチ

ル) コハク酸、2, 3-ジメチルコハク酸、2, 3-ジフェニルコハク酸、2, 3-ジメトキシコハク酸、2, 3-ジェトキシコハク酸、2, 3-ジェトキシコハク酸、2-メチルグルタル酸、2-メチルグルタル酸、2-メトキシグルタル酸、2-メチルアジピン酸、3-メチルアジピン酸、3, 4-ジメチルアジピン酸、カンファー酸、シクロヘキサンジカルボン酸などを示すことができる。

【0073】また、例示2の光学活性な二官能性基の両側を安息香酸基、ナフトエ酸基、[1, 1'ービフェニ 10ル]カルボン酸基、オキシ安息香酸基、オキシナフトエ酸基、オキシ [1, 1'ービフェニル]カルボン酸基、オキシフェニル酢酸基またはオキシ桂皮酸基などで挟む形のジカルボン酸なども好適に用いることができる。

【0074】これらの製造法は先述した一官能性の芳香族基を持つ光学活性カルボン酸誘導体の製造方法と基本的に同一であり、Williamson法の場合に用いることができるトシレート、メシレート、ベンゼンスルホネート、ブロマイド、アイオダイド化合物としては例示2の置換基を有する、ビストシレート、ビスメシレー 20ト、ベンゼンスルホネート、ジブロマイドまたはジアイオダイド化合物などを用いる。また、SNAr法においてアルコキサイドの原料となるアルコールとしては例示2記載の置換基を有する各種ジオール化合物を使用することができる。

【0075】次に、二官能性の芳香族基を持つ光学活性カルボン酸の具体例を示す。以下、例示2に示した置換基の両側に同一の芳香族基を持つ化合物を示すが、本発明では必ずしも同一であることは必要ではなく異なった芳香族基が結合した二官能性の芳香族基を持つ光学活性 30カルボン酸も好適に使用できる。

【0076】まず、安息香酸誘導体の場合、光学活性基による置換位置は一般に2、3、4のいずれの位置が置換されたものも用いることができるが、製造の容易さなどから4置換体が最も好ましく用いることができ、具体的には、4、4'ー(1-メチルエタン-1,2-ジイルビスオキシ)ビス安息香酸、4、4'ー(1-メチルブロパン-1,3-ジイルビスオキシ)ビス安息香酸、4,4'ー(2-メチルブタン-1,4-ジイルビスオキシ)ビス安息香酸、4,4'ー(3-メチルペキサン-1,6-ジイルビスオキシ)ビス安息香酸などを例示できる。

【0077】フェニル酢酸誘導体の場合、光学活性基による置換位置は一般に2、3、4のいずれの位置が置換されたものも用いることができるが、製造の容易さなどから4置換体が最も好ましく用いることができ、具体的には、4,4'-(1-メチルエタン-1,2-ジイルビスオキシ)ビスフェニル酢酸、4,4'-(1-メチルプロパン-1,3-ジイルビスオキシ)ビスフェニル 50

酢酸、4, 4'-(2-メチルブタン-1, 4-ジイル ビスオキシ) ビスフェニル酢酸、4, 4'-(2-メチ ルペンタン-1, 5-ジイルビスオキシ) ビスフェニル 酢酸、4, 4'-(3-メチルヘキサン-1, 6-ジイ ルビスオキシ) ビスフェニル酢酸などを例示できる。

【0078】桂皮酸誘導体の場合、光学活性基による置換位置は一般に2、3、4のいずれの位置が置換されたものも用いることができるが、製造の容易さなどから4置換体が最も好ましく用いることができ、具体的には、4,4'-(1-メチルエタン-1,2-ジイルビスオキシ)ビス桂皮酸、4,4'-(1-メチルブタン-1,4-ジイルビスオキシ)ビス桂皮酸、4,4'-(2-メチルブタン-1,4-ジイルビスオキシ)ビス桂皮酸、4,4'-(3-メチルヘキサン-1,6-ジイルビスオキシ)ビス桂皮酸などを例示できる。

【0079】一方、ナフトエ酸誘導体としては、一般に置換ナフトエ酸のどの異性体も好適に使用できるが、好ましくはカルボン酸基はナフタレンの2の位置にあるものが用いられ、置換基は6または7、好ましくは6の位置にあるものが用いられる。具体的には、6,6'ー (1-メチルエタン-1,2-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (1-メチルプロパン-1,3-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (2-ナフトエ酸)、6,6'ー (3-x)

【0080】さらに、[1, 1'ービフェニル]カルボ ン酸誘導体としては、一般に置換[1,1'ービフェニ ル] カルボン酸のどの異性体も好適に使用できるが、好 ましくはカルボン酸基は [1, 1'ービフェニル] 基の 4の位置にあるものが用いられ、置換基は4'の位置に あるものが用いられる。具体的には、4',4'',-(1-メチルエタン-1, 2-ジイルビスオキシ) ビス ([1, 1'ービフェニル]-4-カルボン酸)、 4', 4''' - (1-メチルプロパン-1, 3-ジイ ルビスオキシ) ビス([1, 1'ービフェニル]ー4ー カルボン酸)、4′,4′′′ー(2-メチルブタン-1, 4-ジイルビスオキシ) ビス([1, 1'-ビフェ ニル] -4-カルボン酸) 、4′, 4′′′ - (2-メ チルペンタン-1, 5-ジイルビスオキシ) ビス ([1, 1'-ビフェニル]-4-カルボン酸)、 4', 4', ', - (3-メチルヘキサン-1, 6-ジイ

【0081】以上、本発明に用いられる光学活性カルボ

カルボン酸)などを例示できる。

ルビスオキシ) ビス([1,1'-ビフェニル]-4-

ン酸に関して述べたが、特に例示1に示される置換基を 二個以上持つ化合物においては、メソ体など本質的に光 学活性となり得ない組み合わせ以外、それぞれ違った構 造のものとを組み合わせた化合物も本発明においては何 ら差し支えなく使用できることを最後に述べておく。以 上に述べた光学活性カルボン酸類および光学活性ジカル ボン酸類は単独化合物あるいは複数の光学活性カルボン 酸混合物として該液晶性化合物の調製に使用することも できる。また必要であるならば、アキラルなカルボン酸 またはその機能性誘導体との混合物を用いることもでき る。

【0082】さらに、アキラルなカルボン酸またはその機能性誘導体のみから製造されたディスコティック液晶性化合物と光学活性なカルボン酸またはその機能性誘導体を含有する原料から製造されたディスコティック液晶性化合物とを混合することによっても本発明に用いられるディスコティック液晶性材料を調製することができる。

【0083】この時に用いられるアキラルなカルボン酸としては、上記光学活性カルボン酸のラセミ体、あるい 20はメゾ体の他、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ウンデカン酸、ドデカン酸、トリデカン酸、テトラデカン酸、オクタデカン酸、ヘキサデカン酸、ヘプタデカン酸、オクタデカン酸、ノナデカン酸、エイコサン酸、4ーペンテン酸、3ーペンテン酸などの炭素数2~30のアルカン酸またはアルケン酸などを例示できる。

【0084】その他に、炭素数7~37、好ましくは炭素数7~27の安息香酸またはその機能性誘導体も好適に使用できる。以下にその例を示すが、置換された安息香酸を用いる場合にはその置換位置に特に制限はなく、2,3,4の位置もすべて好適に使用できるが、好ましくは4の位置の置換体が入手しやすさなどの理由で利用される。

【0085】その具体例として、安息香酸、4ーメチル 安息香酸、4ーエチル安息香酸、4ープロピル安息香酸、4ーイソプロピル安息香酸、4ーイソブチル安息香酸、4ーイソブチル安息香酸、4ーセertーブチル安息香酸、4ーペンチル安息香酸、4ーセーブチル安息香酸、4ーマンチル安息香酸、4ーオクチル安息香酸、4ープニル安息香酸、4ーデシル安息香酸、4ーア・ラデシル安息香酸、4ートリデシル安息香酸、4ーア・ラデシル安息香酸、4ークロロ安息香酸、4ープロモ安息香酸、4ーニトロ安息香酸、4ージメチルアミノ安息香酸、4ーニトロ安息香酸、4ープロポキシ安息香酸、4ーイソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、4ースソプトキシ安息香酸、50

tertーブトキシ安息香酸、4-ペンチルオキシ安息 香酸、4-ヘキシルオキシ安息香酸、4-ヘプチルオキ シ安息香酸、4-オクチルオキシ安息香酸、4-ノニル オキシ安息香酸、4-デシルオキシ安息香酸、4-ウン デシルオキシ安息香酸、4-ドデシルオキシ安息香酸、 4-トリデシルオキシ安息香酸、4-テトラデシルオキ シ安息香酸、3-メチル安息香酸、3-メトキシ安息香 酸酸、3-エトキシ安息香酸、3-プロポキシ安息香 酸、3-ブトキシ安息香酸、3-ペンチルオキシ安息香 酸、3-ヘキシルオキシ安息香酸、3-ヘプチルオキシ 安息香酸、3ーオクチルオキシ安息香酸、3ーノニルオ キシ安息香酸、3-デシルオキシ安息香酸、2-メチル 安息香酸、2-メトキシ安息香酸酸、2-エトキシ安息 香酸、2-プロポキシ安息香酸、2-ブトキシ安息香 酸、2-ペンチルオキシ安息香酸、2-ヘキシルオキシ 安息香酸、2-ヘプチルオキシ安息香酸、2-オクチル オキシ安息香酸、2-ノニルオキシ安息香酸、2-デシ ルオキシ安息香酸などを例示できる。

【0086】また、アキラルなカルボン酸として炭素数 11~41、好ましくは炭素数 11~31のナフトエ酸 誘導体も好適に使用できる。置換されたナフトエ酸誘導体を用いる場合には、その置換位置に特に制限はなく、すべての異性体が好適に使用できるが、好ましくは 2の位置にカルボン酸基、6または7、好ましくは6の位置に置換基が結合したものが入手しやすさなどの理由で利用される。

【0087】その具体例として、2ーナフトエ酸、6ーメチルー2ーナフトエ酸、6ーイソプロピルー2ーナフトエ酸、6ーメトキシナフトエ酸酸、エトキシー2ーナフトエ酸、6ープロポキシー2ーナフトエ酸、6ーブトキシー2ーナフトエ酸、6ーペンチルオキシー2ーナフトエ酸、6ーペープチルオキシー2ーナフトエ酸、6ーオクチルオキシー2ーナフトエ酸、6ーデシルオキシー2ーナフトエ酸などを例示できる。

【0088】さらに、アキラルなカルボン酸として炭素数9~炭素数39、好ましくは炭素数9~29の[1,1'ービフェニル]カルボン酸誘導体も好適に使用できる。置換された[1,1'ービフェニル]カルボン酸誘導体を用いる場合には、その置換位置に特に制限はなく、すべての異性体が好適に使用できるが、好ましくは4の位置にカルボン酸基、4'の位置に置換基が結合したものが入手しやすさなどの理由で利用される。

ン酸、4、-ペンチルオキシ[1,1'-ビフェニル] - 4-カルボン酸、4'-ヘキシルオキシ[1, 1'-ビフェニル] - 4 - カルボン酸、4' - ヘプチルオキシ [1, 1'ービフェニル] - 4 - カルボン酸、4'ーオ クチルオキシ[1,1'ービフェニル]-4-カルボン 酸、4'-ノニルオキシ[1、1'-ビフェニル]-4 -カルボン酸、4'ーデシルオキシ[1,1'ービフェ ニル]-4-カルボン酸などを例示できる。

【0090】さらにアキラルな二官能性のカルボン酸を 使用することもできその具体例として、シュウ酸、マロ 10 ン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン 酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ウンデカ ンジカルボン酸、ドデカンジカルボン酸、トリデカンジ カルボン酸、テトラデカンジカルボン酸、1,4-シク ロヘキサンジカルボン酸、フタル酸、イソフタル酸、テ レフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸、2,5 ーナフタレンジカルボン酸、1,4-ナフタレンジカル ボン酸、1,5-ナフタレンジカルボン酸、[1,1' - ビフェニル] - 4, 4' - ジカルボン酸、フマール 酸、マレイン酸、スチルベン-4,4'-ジカルボン 酸、[1, 1'-ジシクロヘキサン]-4, 4'-ジカルボン酸、ベンゼン-1, 4-ジイルビス (3-プロペ ニル酸)など炭素数2~30、好ましくは炭素数2~2 0のジカルボン酸を挙げることができる。

【0091】さらに安息香酸基、ナフトエ酸基、[1, 1'ービフェニル]カルボン酸基から選ばれる2個の基 により、炭素数2~30、好ましくは炭素数2~20の 脂肪族基、脂環族基、芳香族基などの有機基が挟まれた 形のジカルボン酸も好適に用いることができ、以下にそ の例を示す。安息香酸誘導体を用いる場合一般に2、 3、4のいずれの位置が置換されたものも用いることが できるが、製造の容易さなどから4置換体が最も好まし く用いることができる。また、置換ナフトエ酸を用いる 場合には、一般に置換ナフトエ酸のどの異性体も好適に 使用できるが、好ましくはカルボン酸基はナフタレン環 の2の位置にあるものが用いられ、置換基は6または 7、好ましくは6の位置にあるものが用いられる。置換 [1, 1'ービフェニル] カルボン酸についてもどの異 性体も好適に使用できるが、好ましくはカルボン酸基は [1, 1'ービフェニル] 基の4の位置にあるものが用 いられ、置換基は4′の位置にあるものが用いられる。 【0092】その具体例として、4,4'-(エタン-1, 2-ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4, 4'-(プロパン-1, 3-ジイルビスオキシ) ビス安息香 酸、4,4'-(ブタン-1,4-ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4,4'-(ペンタン-1,5-ジイル ビスオキシ) ビス安息香酸、4,4'-(ヘキサン-1, 6-ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4, 4'-4, 4'- (ヘプタン-1, 7-ジイルビスオキシ) ビ

スオキシ) ビス安息香酸、4,4'-(ノナン-1,9 - ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4,4'- (デカ ン-1, 10-ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4, 4'-(ウンデカン-1, 11-ジイルビスオキシ)ビ ス安息香酸、4,4'-(ドデカン-1,12-ジイル ビスオキシ) ビス安息香酸、4,4'- (ベンゼンー 1, 4-ジイルビスオキシ) ビス安息香酸、4, 4'- $(\overset{\checkmark}{\sim})$ オキシ) ビス安息香酸、4,4'-(シクロヘキサンー 安息香酸、

32

【0093】6,6'-(エタン-1,2-ジイルビス オキシ) ビス(2-ナフトエ酸)、6,6'-(プロパ ン-1, 3-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ 酸)、6,6'-(ブタン-1,4-ジイルビスオキ シ) ビス (2-ナフトエ酸)、6,6'- (ペンタン-1,5-ジイルビスオキシ)ビス(2-ナフトエ酸)、 6, 6'-(ヘキサン-1, 6-ジイルビスオキシ) ビ ス (2-ナフトエ酸) 、6 , 6'-6 , 6'-(へプタ ン-1, 7ージイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ 酸)、6,6'-(オクタン-1,8-ジイルビスオキ シ) ビス(2-ナフトエ酸)、6,6'-(ノナンー 1, 9-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、 6, 6'-(デカン-1, 10-ジイルビスオキシ) ビ ス (2-tフトエ酸)、6, 6, 6, - (ウンデカン-1, 11-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、 6, 6'-(ドデカン-1, 12-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、6,6'- (ベンゼン-1, 4-ジイルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸) 、<math>6、 ルビスオキシ)ビス (2-ナフトエ酸)、6,6'-(シクロヘキサンー1, 4-iジメチルーα, α) ージイ ルビスオキシ) ビス (2-ナフトエ酸)、4', 4'', - (エタン-1, 2-ジイルビスオキシ) ビス ([1, 1'-ビフェニル]-4-カルボン酸)、 4', 4''' - (プロパン-1, 3-ジイルビスオキ シ) ビス([1, 1'ービフェニル]ー4ーカルボン 酸)、4′,4′′′ー(ブタン-1,4-ジイルビス オキシ) ビス([1, 1'ービフェニル]ー4ーカルボ ン酸)、4′,4′′′ー (ペンタン-1,5-ジイル ビスオキシ) ビス([1, 1'ービフェニル]ー4ーカ ルボン酸)、4′,4′′′ー(ヘキサン-1,6-ジ イルビスオキシ) ビス ([1, 1'ービフェニル]ー4 -カルボン酸)、4′, 4′′′ - (ヘプタン-1, 7ージイルビスオキシ) ビス([1, 1'ービフェニル] -4-カルボン酸)、4′,4′′,- (オクタン-1,8-ジイルビスオキシ)ビス([1,1'-ビフェ ニル] -4-カルボン酸)、4′,4′′′ー(ノナン -1, 9-ジイルビスオキシ) ビス([1, 1'-ビフ ス安息香酸、4, 4'ー(オクタンー1, 8ージイルビ 50 ェニル]ー4ーカルボン酸)、4', 4'''ー(デカ

8, 9, 12, 13-オクタカルボン酸、ベンゼン-1, 3, 5-トリカルボン酸、トルクセン-2, 3,

34

7, 8, 12, 13-ヘキサカルボン酸である。

v-1, $10-\bar{v}$ イルビスオキシ)ビス($\begin{bmatrix} 1, 1'-\bar{v} \\ 1, 1'-\bar{v}$

【0094】また、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコールなどの2個の末端ヒドロキシ基をヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシナフトエ酸、ヒドロキシ [1, 1'ービフェニル]カルボン酸のヒドロキシ基とエーテル結合を形成させて得られる化合物も使用できる。さらにこれら安息香酸、ナフト20工酸、[1, 1'ービフェニル]カルボン酸基を含む二官能性カルボン酸では、両側が、例えば片方が安息香酸基、もう片方がナフトエ酸基のように違った化合物でも差し支えなく使用できる。

【0095】一方、ディスコゲンと成りうる化合物の置 換部位がカルボキシル基を持つ場合には、カルボキシル 基と例示1の基を持つアルコールとの間にエステル結合 を作ることができるが、その方法はエステル交換法、酸 ハロゲン化物法、酸無水物法、ジシクロヘキシルカルボ ジイミドを用いる方法など公知の方法を採ることができ る。この時用いることができるディスコゲンとなりうる 化合物としては、トリフェニレンー2,3,6,7,1 0, 11-ヘキサカルボン酸、ジベンゾ [fg, op] ナフタセンー1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13ーオ クタカルボン酸、ベンゼンー1,3,5ートリカルボン 酸、トルクセンー2,3,7,8,12,13-ヘキサ カルボン酸、トリオキサトルクセン-2,3,7,8, 12, 13-ヘキサカルボン酸、アントラキノン-1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサカルボン酸、4-(2, 6 ービス (4ーヒドロキシカルボニルフェニル) -4H-ピランー4ーイリデン) -2, 6-ビス (4-ヒドロキ シカルボニルフェニル) - 4 H-ピラン、ピラン-1, 3, 6, 8-テトラカルボン酸、(ベンゼン-1, 3, 5ートリカルボキシ) -6, 6', 6''ートリス (ナ フタレンー2-カルボン酸)、(ベンゼンー1、3、5 ートリカルボキシ) - 4, 4', 4''ートリ安息香酸 などを挙げることができる。

【0096】これらの中で好ましくは、トリフェニレン -2,3,6,7,10,11-ヘキサカルボン酸、ジ ベンソ[fg,op]ナフタセン-1,2,5,6,

【0097】また、これらのカルボン酸を有するディス コゲンとなりうる化合物とエステル結合を形成し得る光 学活性アルコールは炭素数3~30、好ましくは炭素数 3~20のアルコールであり、具体的には例示1に記載 の置換基を有する光学活性なアルコールを1種または複 数用いることができる。さらにアキラルなアルコールと の混合物を用いることもできる。この時用いることがで きるアキラルなアルコールは炭素数1~30好ましくは 炭素数1~20のアルコールであり、脂肪族、脂環族ア ルコール、具体的にはメタノール、エタノール、プロパ ノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノー ル、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オク タノール、ノナノール、デカノール、ウンデカノール、 ドデカノール、トリデカノール、テトラデカノール、ス テアリルアルコール、シクロヘキサノール、などを例示 することができる。

【0098】以上、ディスコゲンと成りうる化合物のヒドロキシ基あるいはメルカプト基のアルキル化、該化合物のヒドロキシ基あるいはメルカプト基のエステル化、および該化合物のカルボキシル基のエステル化、について詳細に述べたが、特にヒドロキシ基あるいはメルカプト基を持つディスコゲンと成りうる化合物の場合、その一部をアルキル化し、残りをエステル化するような製造方法も可能である。

【0099】以上のようにして得られた光学活性な置換 基を持つディスコティック液晶性化合物は、必要であれ ばアキラルなディスコティック液晶性化合物と混合して 本発明に用いられるディスコティック液晶性材料とする ことができる。この時、光学活性な置換基濃度は必要と されるねじれの大きさにより決定されるが、一般にすべ ての置換基を光学活性な基とすることは、高価な原料を 大量に使用しなければならない。通常、光学活性なディ スコティック液晶性化合物を単独で該材料として用いる 場合、光学活性な置換基成分は全置換基成分に対して通 常0.001~100モル%、好ましくは0.01~5 0モル%、さらに好ましくは0.1~30モル%の範囲 である。また、組成物、例えば置換基が全て光学活性な ディスコティック液晶性化合物と置換基が全てアキラル な該化合物との組成物として該材料に用いる場合には、 光学活性なディスコティック液晶性化合物の光学活性な 置換基成分は、光学活性なディスコティック液晶性化合 物が有する置換基成分とアキラルなディスコティック液 晶性化合物が有する置換基成分を足した全置換基成分に 対して通常0.001~100モル%、好ましくは、 0.01~50モル%、さらに好ましくは0.1~30

0.01~50モル%、さらに好ましくは0.1~30モル%の範囲である。したがって、複数の光学活性なデイスコティック液晶性化合物または複数の光学活性なデ

イスコティック液晶性化合物と複数のアキラルなディスコティック液晶性化合物との混合物を該材料として用いる場合にも、光学活性な置換基成分が、上記の割合となるように混合すればよい。なお、組成物として用いる場合、光学活性な置換基の割合が上記の割合となるように、固体混合、溶液混合あるいはメルト混合などの方法でもって混合し、該混合物を調製する。

【0100】本発明に用いられるディスコティック液晶性化合物の製造において、ある一個のディスコゲンと成りうる化合物の特定の置換部位に特定の置換基を導入す 10 る、というような高度な選択性制御を行う必要は全くない。したがってディスコゲンとなりうる化合物と置換基となりうる複数の異なった化合物とを一つの反応容器内で同時に反応させ、異なった複数の置換基を有するディスコティック液晶性化合物を本発明に使用することができる。またこの際に複数のディスコゲンと成りうる化合物と置換基となりうる複数の光学活性な該化合物および複数のアキラルな該化合物とを混合して所望のディスコ*

* ティック液晶性化合物を製造して得られた該液晶性化合 物も本発明においては好適に用いることができる。もち ろん、この場合得られる化合物は多様な置換基分布の化 合物の混合物となるが、本発明では液晶相からの結晶相 への転移が起こっては望ましくないので、例えば分子の 対称性を低下させるなど、上記のごとき多種類の置換基 となりうる化合物を用いることは好ましい態様である。 さらに、異なった置換基組成のディスコティック液晶性 化合物同士を混合して用いることも全く差し支えない。 【0101】なお以上説明したディスコティック液晶性 化合物からなる該液晶性材料は、光学活性なディスコテ イック液晶性化合物および/またはアラルキルなディスト コティック液晶性化合物のみから実質的になる該液晶性 材料であることが望ましい。以上説明したディスコティ ック液晶性を構成するディスコティック液晶性化合物の 具体的な構造を以下に示す。

【0102】 【化1】

$$\begin{array}{c} R_1 \\ O \\ CO \\ O \\ C \end{array}$$

【0103】(ただし、R1、R2、R3は、 C_n H 2_{n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1 種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0104] [化2]

【0105】(ただし、R1、R2、R3は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換50 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく

は3以上14以下の整数である。)

[0106]

*【化3】

【0107】 (ただし、R1、R2、R3は、C。H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個 ※

※は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 20 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0108]

【化4】

【0109】 (ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0110]

【化5】

$$R_1$$

【0111】 (ただし、R1、R2、R3は、C。H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 20 は3以上14以下の整数である。) 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個 *

*は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく

[0112]

【化6】

【0113】 (ただし、R1は、Cn H2n+1 れる直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に 記載した置換基から選ばれる。B1および/またはB2 は(a) および(b) から選ばれる少なくとも1種の結 合手であり、Qは、Cm H2m で表される直鎖もしくは 40 分岐したアルキレン基、または例示2に記載された置換 基である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の 場合、R1は例示1に記載の置換基を有するまたはB1

もしくはB2のうち少なくとも1つが、Qに例示2に記 載された光学活性な置換基を有する。ここで n は 1 以上 18以下の整数、好ましく3以上14以下の整数、また mは2以上16以下の整数、好ましくは4以上12以下 の整数である。平均分子量は、3,000から10,0 00の範囲である。)

[0114]

【化7】

【0115】 (ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 20 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

*は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0116]

【化8】

【0117】 (ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 40 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0118]

【化9】

【0119】 (ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個 は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0120]

【化10】

【0121】 (ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個 は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0122]

【化11】 30

【0123】(ただし、R1、R2、R3は、C H 2 n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1 に記載した置換基から選ばれる1 種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個 *

*は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

46

[0124]

【0125】(ただし、R1、R2、R3は、Cn H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 40 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。)

[0126]

【化13】

【0127】(ただし、R1は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる。B1 および/またはB2 は (a), (b) および (c) から選ばれる少なくとも1種の結合手であり、Q は、 C_m H_{2m} で表される直鎖もしくは分岐したアルキレン基、または例示2に記載さ 20れた置換基である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合、R1は例示1に記載の置換基を有するまたはB1 もしくはB2 のうち少なくとも1つが、Q にの示2に記載された光学活性な置換基を有する。ここで R は以上18以下の整数、好ましく3以上14以下の整数、またmは2以上16以下の整数、好ましくは4以上12以下の整数である。平均分子量は、3,000から10,000の範囲である。)

[0128] [化14] R₁ R₂

【0129】 (ただし、R1、R2、R3、R4は、C H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル 基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種ま

たは複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

【0130】 【化15】

【0131】(ただし、R1、R2、R3、R4は、C $_{n}$ H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $_{n}$ 1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0132]

【化16】

【0133】(ただし、R1、R2、R3、R4は、C * H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル 基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種ま 20 たは複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なく* R_1 - O 、

*とも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、 好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0134]

【化17】

【0135】 (ただし、R1、R2、R3、R4は、C n H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル 40 基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なく

とも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活 0 性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、 好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0136]

【化18】

【0137】(ただし、R1、R2、R3、R4は、C $_{n}$ H $_{2\,n+1}$ で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $_{n}$ に記載の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0138]

【0139】(ただし、R1、R2、R3、R4は、C 所 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1 種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なくとも1 個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0140]

【化20】

【0141】(ただし、R1、R2、R3、R4は、C $_{\rm n}$ H $_{\rm 2n+1}$ で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $_{\rm n}$ は1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

【化21】

【0143】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下

の整数である。)

[0144]

【化22】

【0145】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、C。H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0146]

【化23】

【0147】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 20 の整数である。) 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載*

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下

[0148]

【化24】

【0149】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5, R611, Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 50

4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0150]

【化25】

【0151】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、C 。 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0152]

【化26】

【0153】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R30 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0154]

【化27】

【0155】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載*30

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

【0156】 【化28】

$$\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{X} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{O-R_{2}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{G-X-y} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\$$

【0157】で表される組成物。カッコ横の数字はモル組成比を表す。(ただし、R1、R2、R3は、C 、H2 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。また、XおよびYは、 $0 \le X \le 6$ 、 $0 \le Y \le 6$ 、 $X+Y \le 6$ である。)

[0158]

【化29】

【0159】で表される組成物。カッコ横の数字はモル 10*1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基であ 組成比を表す。(ただし、R1、R2は、C。H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2のうち少なくとも1個は、例示*

【0161】で表される組成物。カッコ横の数字はモル 組成比を表す。(ただし、R1、R2、R3は、C。H で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、 または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または 30 $0 \le X \le 6$ 、 $0 \le Y \le 6$ 、 $X + Y \le 6$ である。) 複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物 の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

る。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以 上14以下の整数である。また、Xは、0≦X≦6であ る。)

$$\begin{bmatrix}
0 & 1 & 6 & 0 \\
[(E & 3 & 0)]
\end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
C & -R_1 \\
O & -R_2
\end{pmatrix}_{y}$$

$$\begin{pmatrix}
C & -R_2 \\
O & -R_3
\end{pmatrix}_{6-x-y}$$

は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく は3以上14以下の整数である。また、XおよびYは、

[0162] 【化31】

【0163】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、 C_6 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1 種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6の5ち少なくとも1個は、例示1に記載*

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $n \, t \, 1 \, U \, L \, 1 \, 8 \, U \, T \, O$ 整数、好ましくは $3 \, U \, L \, 1 \, 4 \, U \, T$ の整数である。また、 $k \, t \, t \, 1 \, \ldots \, 2$ または $3 \, C$ である。)

【0164】 【化32】

【0165】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R ル基、5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、またにCn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキ 50 る。)

ル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種 または複数である。Qは、次の一般式で示す置換基であ る)

67

など

れる光学活性な置換基またはQの置換基が、上記一般式におけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は、3,000から10,000の範囲である。)

[0168]

【化34】

【0169】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。Qは、前記した置換基である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置*

* 換基から選ばれる光学活性な置換基またはQにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は、3,000から10,000の範囲である。)

【0170】 【化35】

* 1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基または QにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光

[0172]

【化36】

72

学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の

整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は3,000から10,000の範囲である。)

【0171】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、C。H2a+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。Qは、前記一般式に記載された置換基である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10のうち少なくとも1個は、例示*

【0173】で表されるポリマー。(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7 、R8は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。Qは、前記一般式に記載された置換基である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5 、R6 、R7、R8のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基またはQにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は5, 000から100, 000の範囲である。)

【0174】 【化37】

R₆ S S R₂

R₈ S R₄

【0175】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R

5、R 6 は、Cn H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1 に記載した置換基から選ばれる1 種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R 1 、R 2 、R 3 、R 4 、R 5 、R 6 のうち少なくとも1 個は、例示1 に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでn は1 以上1 8 以下の整数、好ましくは3 以上1 4 以下の整数である。)

[0176]

【化38】

40

【0177】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分 50 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から

選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで*

* nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

74

[0178]

【化39】

$$\begin{array}{c} R_1 \\ CO \\ CO \\ S \\ O \\ S \\ CO \\ R_2 \\ \end{array}$$

【0179】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、C。H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載※

※の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0180]

【化40】

【0181】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 50 5、R6は、Cn H2n+: で表される直鎖もしくは分

岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで* * nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

【0182】 【化41】

【0183】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R304、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0184]

【化42】

【0185】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 30

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0186]

【化43】

【0187】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、C H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載*30

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

【0188】 【化44】

'

$$\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{y}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{6}-\mathbf{x}-\mathbf{y}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{6}-\mathbf{x}-\mathbf{y}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{6}-\mathbf{x}-\mathbf{y}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{7}} \\
\left(\begin{array}{c} C \\ O \\ \end{array}\right)_{\mathbf{7}}$$

【0189】で表される組成物。カッコ横の数字はモル組成比を表す。(ただし、R1、R2、R3は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

は、例示 1 に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでn は 1 以上 1 8 以下の整数、好ましくは 3 以上 1 4 以下の整数である。また、X および Y は、 $0 \le X \le 6$ 、 $0 \le Y \le 6$ 、 $X + Y \le 6$ である。)

[0190]

【化45】

$$\begin{array}{c} R_{1} \\ R_{2} \\ R_{3} \\ R_{4} \\ R_{5} \\ R_{5} \\ R_{6} \\ R_{7} \\ \end{array}$$

【0191】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、 で表される直鎖もしくは分岐したアルキ ル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種 または複数である。Qは、前記に記載された置換基であ る。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合に は、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R 8、R9、R10のうち少なくとも1個は、例示1に記*

*載の置換基から選ばれる光学活性な置換基またはQにお 20 けるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性 な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、 好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量 は、3,000から10,000の範囲である。)

[0192]【化46】

【0193】で表されるポリマー。 (ただし、R1、R 2, R3, R4, R5, R6, R5, R6, R7, R8 は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したア ルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる 1種または複数である。Qは、前記に記載された置換基 Qと同一である。光学活性なディスコティック液晶性化 合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R 6、R7、R8のうち少なくとも1個は、例示1に記載 50 の置換基から選ばれる光学活性な置換基またはQにおけ るAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性な 置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好 ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は 5,000から100,000の範囲である。)

[0194]

【化47】

【0195】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで20nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0196]

【0199】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

* [化48]
R₁
O
R₂
O
R₃
O
R₄

84

【0197】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、Cn H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

【0198】 【化49】

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0200]

【化50】

【0201】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R304、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0202]

【化51】

【0203】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0204]

【化52】

【0205】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、C0 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

R1、R2、R3、R4、Rの置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでで表される直鎖もしくは分 30 nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下は例示1に記載した置換基からの整数である。)

[0206]

【化53】

【0207】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載*30

【0209】で表される組成物。カッコ横の数字はモル組成比を表す。(ただし、R1、R2、R3は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0208]

【化54】

$$\begin{pmatrix}
c & & \\
c$$

は、例示 1 に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでn は 1 以上 1 8 以下の整数、好ましく は 3 以上 1 4 以下の整数である。また、X およびY は、 $0 \le X \le 6$ 、 $0 \le Y \le 6$ 、 $X + Y \le 6$ である。)

[0210]

【化55】

$$\begin{pmatrix}
C & \longrightarrow & R_1 \\
O & \longrightarrow & R_2
\end{pmatrix}_{\mathbf{G}-\mathbf{X}}$$

【0211】で表される組成物。カッコ横の数字はモル組成比を表す。(ただし、R1、Rは、Cn H2n+1で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2のうち少なくとも1個は、例示1に記載*

【0213】で表される組成物。カッコ横の数字はモル組成比を表す。(ただし、R1、R2、R3は、C 、H20+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3のうち少なくとも1個

*の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで n は 1 以上 1 8 以下の整数、好ましくは 3 以上 1 4 以下 の整数である。また、X は、0 \leq X \leq 6 である。)

【0212】 【化56】

$$\begin{pmatrix}
C - R_1 \\
C - R_2
\end{pmatrix}_{\mathbf{y}}$$

$$\begin{pmatrix}
C - \mathbf{R}_2 \\
C - \mathbf{R}_3
\end{pmatrix}_{\mathbf{6}-\mathbf{x}-\mathbf{y}}$$

は、例示 1 に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換 基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましく 30 は3以上14以下の整数である。また、XおよびYは、 $0 \le X \le 6$ 、 $0 \le Y \le 6$ 、 $X + Y \le 6$ である。)

【0214】 【化57】

【0215】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載*30

* の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。また k は、1、2、もしくは3であ る。)

[0216]

【0217】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 50 5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、

C。 H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。 Qは、前記に記載された置換基である。 光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基またはQにお*

* けるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は、3,000から10,000の範囲である。) 【0218】 【化59】

【0219】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7、R8 、R9 、R10は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。Qは、前記に記載した置換基Qと同一である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6 、R7 、R8 、R9 、R10 のうち少なくとも1個は、例示

30 1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基または QにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光 学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の 整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分 子量は、3,000から10,000の範囲である。) 【0220】

【化60】

【0221】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7、R8、R9、R10は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。Qは、前記に記載した置換基Qと同一である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10のうち少なくとも1個は、例示*

* 1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基または QにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光 学活性な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の 整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分 子量は、3,000から10,000の範囲である)

[0222] 【化61】

【0223】で表されるポリマー。(ただし、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R5、R6、R7、R8は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる50

1種または複数である。Qは、前記に記載した置換基Qと同一である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置

101

換基またはQにおけるAが例示2から選ばれる少なくと も1種の光学活性な置換基を有する。ここでnは1以上 18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数であ る。平均分子量は5,000から100,000範囲 である。)

[0224]

【化62】

【0225】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで* *nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

102

[0226]

【化63】

【0227】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0228]

【化64】

【0229】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R で表される直鎖もしくは分 5、R6は、Cn H2n+1 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から

イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ 50 nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下

103

の整数である。) [0230]

*【化65】

【0231】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 30 【化66】 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載

の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0232]

【0233】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R 5、R6は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分 岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から 選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコテ イック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R 4、R5、R6のうち少なくとも1個は、例示1に記載 の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで nは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下 の整数である。)

[0234]

【化67】

合には、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基またはQにおけるAが例示2から選ばれる少なくとも1種の光学活吐な置換基を有する。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。平均分子量は5,000から100,000の範囲である。)

【0254】また上記の如き構造式を有する化合物を側鎖に持つ、例えばポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリシロキサンなどのポリマーも好適に用いられる。具体的には、

[0255]

【化77】

【0256】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選30ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0257]

【化78】

【0258】 (ただし、R1、R2、R3、R4、R5 晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5 は、C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したア のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる 50 ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18

120

1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0259]

【化79】

【0260】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

【0261】 【化80】

20

40

【0262】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、Cn H2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な関換基である。ここでPは1以上18

121

以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0263] [化81]

【0264】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C $_{\rm n}$ H $_{\rm 2n+1}$ で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $_{\rm n}$ は1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0265]

【化82】

【0266】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C。 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活けなディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

122

[0267] 【化83]

【0268】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、Cn H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0269]

【化84】

30

【0270】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5 40 は、 C_0 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0271]

【化85】

【0272】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0273] [化86]

【0274】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C。 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液 40晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0275] [化87]

【0276】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C $_0$ H $_{2n+1}$ で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここで $_1$ は1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0277]

【化88】

30

$$\begin{array}{c} \leftarrow \text{CH-CH}_2 \\ \leftarrow \text{CO} \\ \downarrow \text{CO} \\ \downarrow \text{O} \\ \downarrow \text{O}$$

【0278】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C。 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0279]

【化89】

126

【0280】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、Cn H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18 20以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0281] [化90]

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH-CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CO \\
O \\
O \\
C-R_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C-R_{3} \\
C-R_{3}
\end{array}$$

【0282】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、C。 H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

[0283]

[任91]
$$\begin{pmatrix} CH_1 \\ CH-CH_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} CH_2 \\ CO \\ O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O-C-R_1 \\ O \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C-R_1 \\ O \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C-R_2 \\ O \end{pmatrix}$$

【0284】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、CnH2n+1 で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる1種または複数である。光学活性なディスコティック液30晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数である。)

【0285】 【化92】

30

【0286】(ただし、R1、R2、R3、R4、R5は、 C_n H_{2n+1} で表される直鎖もしくは分岐したアルキル基、または例示1に記載した置換基から選ばれる 1種または複数である。光学活性なディスコティック液晶性化合物の場合には、R1、R2、R3、R4、R5のうち少なくとも1個は、例示1に記載の置換基から選ばれる光学活性な置換基である。ここでnは1以上18以下の整数、好ましくは3以上14以下の整数であり、またmは、2以上16以下の整数、好ましくは4以上12以下の整数である。)

なお、上記ポリマーの平均分子量は、5,000以上1 00,000以下の範囲である。

【0287】以上例示した構造は、ディスコティック液 晶性化合物の典型的な例であり、本発明に用いられるデ ィスコティック液晶性材料を構成する該化合物は、これ らに限定されるものではなく、上述した性質を有するも のであれば、如何なる構造のディスコティック液晶性化 合物でも単独または混合物として使用することができ る。上記のごときディスコティック液晶性材料を用い て、均一にねじれ配向・固定化した液晶性光学フィルム 40 を得るには、以下に説明する基板および各工程を踏むこ とが本発明において好ましい。まず、ディスコティック 液晶性材料を配向基板上に塗布する。本発明に用いるこ とのできる配向基板は、液晶の傾く向きを規定できるよ うに、異方性を有している基板であることが望ましい。 配向基板が、全く液晶の傾く向きを規定できない場合に は、無秩序な方位に傾いた構造しか得られず望む光学的 性能は得られない。

【0288】本発明に用いることのできる配向基板とし ビングポリアリレート基板、ラビンク て、具体的には次のような面内の異方性を有している材 50 スチック基板を挙げることができる。

料が望ましく、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルケトン・ポリケトンサルファイド、ポリエーテルスルフォン、ポリスルフォン・ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリアリレート、ポリアリレート、ポリアリレート、ポリアリレート、ポリアリレート、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、アクリル村のプラスチックフィルム基板および一軸延伸フィルム基板、表面にスリット上の溝をつけたアルミニウム、鉄、銅などの金属基板、表面をスリット状にエッチング加工したアルカリガラス、ホウ珪酸ガラス、フリントガラスなどのガラス基板、などを例示できる。

【0289】本発明においては上記基板に、親水化処理や疎水化処理などの表面処理を施した上記各種基板で処理を施した上記とでした。また上記プラスチックフィルム基板にラビングプラスチックフィルム基板、またができる上記とでは、ラビングポリビニルアルコール膜などを有する上記各種基板なども用いることができる。を有する上記各種基板なども用いることができる。を有する上記各種基板なども用いることができる基板では、ラビングポリイミド膜を有する基板、ラビングポリエーテルエーテルケトン基板、ラビングポリエーテルスルフォン基板、ラビングポリエーテレフレート基板、ラビングポリエチレンナフタレート基板、ラビングポリエチレンナスチック基板、ラビングポリエチレンナフタレート基板、ラビングポリアリレート表板、ラビングセルロース系プラスチック基板を挙げることができる

【0290】本発明の液晶性光学フィルムは、これらの配向基板上に前記のディスコティック液晶性材料を塗布し、ついで均一配向過程、固定化過程を経て得られる。ディスコティック液晶性材料の塗布は、各種溶媒に該材料を溶解した溶液、あるいは、該材料を溶融した状態のものを用いて行うことができるが、プロセス上、溶媒にディスコティック液晶性材料を溶解した該溶液を用いて塗布する、溶液塗布法が望ましい。

【0291】溶液塗布について説明する。まず、ディス コティック液晶性材料を溶媒に溶かし所定濃度の溶液を 調製する。この際の溶媒の選択は該液晶性材料、あるい は塗布に適当な粘度などにより変化し得るが、通常、常 圧での沸点が30~300℃、好ましくは60~250 ℃の範囲にあるものが用いられ、具体例としてベンゼ ン、トルエン、キシレン、テトラリン、メチルナフタレ ンなどの芳香族炭化水素類、ヘキサン、シクロヘキサ ン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカリンなどの鎖状 あるいは環状脂肪族炭化水素類、アセトン、メチルエチ ルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチル エーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジェ チレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングルコ ールジエチルエーテルなどのエーテル類、塩化メチレ ン、クロロホルム、ジクロロエタン、テトラクロロエタ ン、四塩化炭素、トリクロロエチレン、テトラクロロエ チレン、オルソジクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化 水素類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ ド、N-メチルピロリドンなどのアミド類、メタノー ル、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノ ール、ヘキサノール、エチレングリコール、プロピレン グリコール、メトキシエタノール、エトキシエタノー ル、プロポキシエタノール、ブトキシエタノール、ジエ チレングリコール、ジプロピレングリコール、ジエチレ ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノエチルエーテルなどのアルコール類、フェノー ル、パラクロロフェノール、クレゾールなどのフェノー ル類、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、エチレ ングリコールジアセテート、γーブチロラクトンなどの カルボン酸エステルあるいはラクトン類、エチレンカー ボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネ 40 ート、ジエチルカーボネートなどの炭酸エステル類、ジ メチルスルホキサイド、スルホランなどのスルホン類、 アセトニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル類、あ るいは水およびこれらの混合物などを用いることもでき る。

【0292】溶液の濃度は、該液晶性材料の溶解性や最終的に目的とする液晶性光学フィルムの膜厚に依存するため一概には言えないが、通常、1~60重量%で使用され、好ましくは3~40重量%の範囲である。これらのディスコティック液晶性材料溶液を、次に上記の配向 50

基板上に塗布する。塗布の方法としては、スピンコート法、ロールコート法、プリント法、カーテンコート法 (ダイコート法)、浸漬引き上げ法などを採用できる。塗布後、溶媒を除去し、基板状に膜厚の均一な液晶性材料の層を形成させる。溶媒除去条件は特に限定されず、溶媒がおおむね除去でき、該液晶性材料の層が流動したり流れ落ちたりさえしなければ良い。通常、室温での起気、ホットプレート上での乾燥、乾燥炉での乾燥、温風や熱風の吹き付けなどを利用して溶媒を除去する。この塗布・乾燥工程の段階は、まず基板上に均一にディスコティック液晶性材料の層を形成させることが自的であり、通常該液晶性材料層はまだ目的の配向を形成していない。目的の配向を形成するためには次の熱処理を行うことが本発明においては好ましい。

【0293】熱処理は、ディスコティック液晶性材料の 液晶転移点以上で行う。すなわち該液晶性材料の液晶状 態で配向させるか、または、一旦液晶層を呈する温度範 囲よりもさらに高温の等方性液体状態にした後、液晶層 を呈する温度範囲にまで降温することにより行う。熱処 理温度は、ディスコティック液晶性材料により異なるた め一概には言えないが、通常50~300℃の温度範囲 で行われ、特に100~250℃の範囲が好適である。 また、液晶が十分な配向をするために必要な時間は、デ ィスコティック液晶性材料により異なるため一概には言 えないが、通常5秒~2時間の範囲で行われ、好ましく は10秒~40分の範囲、特に好ましくは20秒~20 分の範囲である。5秒より短い場合、該液晶性材料層の 温度が所定温度まで上がりきらず配向不十分となる恐れ があり、また、2時間より長い場合には、生産性が低下 する恐れがある。なお、本発明では、上記の熱処理工程 において、該液晶性材料の磁化率異方性または誘電異方 性を利用して、磁場や電場を用いることにより、ディス コティック液晶性材料の配向形態を制御、または配向形 態形成を促進させることもできる。より詳しくは、磁場 の印加下では通常芳香環は反磁性を示すため、芳香環平 面が磁場と平行になろうとする力が働く。一方、電場の 印加下では、分子の双極子モーメントが電場と平行にな ろうとする力が働く。このそれぞれの力を利用し、任意 の方向から磁場または電場を印加することにより、フィ ルム内部のディスコティック液晶性化合物分子の配向方 向を制御し、所望の配向形態にする。磁場を印加する場 合、その強さは一般に O. 1 KGから 1 O KGの範囲で あり、電場を印加する場合、その強さは一般に100K V/mから10MV/mの範囲である。

【0294】こうして得られたディスコティック液晶のねじれ配向を、次に冷却することにより、該配向形態を損なうことなく固定化し、本発明の液晶性光学フィルムを得る。一般に、冷却の過程で結晶層が出現する場合、液晶状態における配向は結晶化に伴い破壊されてしまう。本発明に用いるディスコティック液晶性材料は、結

晶相を全く有しないか、潜在的に結晶相を有していても 冷却時には結晶相が現れない性質を持ったもの、あるい は明瞭な結晶転移点および液晶転移点は確認されないけ れども、液晶性光学フィルムの使用温度範囲内において は流動性が無く、且つ、外場や外力を加えても配向形態 が変化しない、というような性質のものを用いるため、 結晶化による配向形態の破壊は起こらない。

【0295】本発明の液晶性光学フィルムは、ディスコ ティック液晶性材料の液晶転移点以下に冷却することに より好適な該フィルムを得ることができる。冷却は熱処 理雰囲気中から室温中に取り出すだけで均一に固定化す ることができる。また、空冷、水冷などの強制冷却、徐 冷などを行っても何ら差し支えなく、さらに冷却速度に も特に制限はないが、あまりに長い時間をかけての徐冷 は生産性の低下を招く。また、潜在的な結晶層などの出 現を促す可能性があり望ましくない。通常、冷却に必要 な時間は30分以下、好ましくは10分以下である。

【0296】固定化後の液晶性光学フィルムの膜厚は、 用途により一概には言えないが、10 n m~100 μ m の範囲が好ましく、特に100nm~50μmの範囲が 好ましい。 膜厚が 10 nm未満の場合、複屈折性が小さ く十分な光学性能が得られ難く、また、膜厚が 1 0 0 μ mを越える場合には製造時に配向欠陥が出やすくなるの で好ましくない。以上の工程によって得られる本発明の 液晶性光学フィルムは、特異な配向形態を有するが故に 今までにない光学特性を発揮する。その光学特性を利用 し、該フィルムを液晶ディスプレーなどの視野角や色な どの補償手段として使用することができる。本発明の液 晶性光学フィルムを液晶表示素子用補償フィルム(以 後、補償フィルムと略す)として実際に液晶セルに配置 30 . する場合、該フィルムの使用形態として上述の配向基板 を該フィルムから剥離して、フィルム単体で用いる、配 向基板上に形成したそのままの状態で使用する、という ことが可能である。

【0297】フィルム単体として用いる場合には、配向 基板を該フィルムとの界面で、ロールなどを用いて機械 的に剥離する方法、構造材料すべてに対する貧溶媒に浸 漬した後機械的に剥離する方法、貧溶媒中で超音波をあ てて剥離する方法、配向基板と該フィルムとの熱膨張係 数の差を利用して温度変化を与えて剥離する方法、配向 基板そのもの、または配向基板上の配向膜を溶解除去す る方法などを例示することができる。剥離性は、用いる ディスコティック液晶性材料と配向基板の密着性によっ て異なるため、その系に最も適した方法を採用すべきで ある。

【0298】次に、配向基板上に形成した状態で補償フ ィルムを用いる場合、配向基板が透明で光学的に等方で あるか、あるいは配向基板が液晶表示装置にとって必要 な部材である場合には、そのまま目的とする液晶表示素 子として使用することができる。さらに配向基板上でデ 50 行うことができる。剥離の方法は、上述でも説明した

イスコティック液晶性材料を配向固定化して得られた本 発明の補償フィルムを該基板から剥離して、光学用途に 応じて、それに適した別の基板上に移しかえて使用する こともできる。

【0299】例えば、使用する配向基板が、目的とする 配向形態を得るために必要なものではあるが、液晶表示 装置に対して好ましくない影響を与えるような該基板を 用いた場合、その基板を配向固定化後の補償フィルムか ら除去し、別の基板に移しかえることができる。具体的 には次のような方法を採用できる。目的とする液晶表示 装置に組み込む液晶表示素子に適した基板(以下、第二 の基板と称する)と配向基板上の補償フィルムとを、接 着剤または粘着剤を用いて貼り付ける。次に、配向基板 と本発明の補償フィルムの界面で剥離し、補償フィルム を液晶表示素子に適した第二の基板側に転写して液晶表 示素子を製造することが可能である。

【0300】転写に用いられる第二の基板としては、適 度な平面性を有するものであれば特に限定されないが、 ガラスおよび透明で光学的等方性を有するプラスチック フィルムが好適である。かかるプラスチックフィルムの 例としては、ポリメタクリレート、ポリスチレン、ポリ カーボネート、ポリエーテルスルフォン、ポリフェニレ ンサルファイド、ポリアリレート、アモルファスポリオ レフィン、トリアセチルセルロース、あるいはエポキシ 樹脂などを挙げることができる。中でもポリメチルメタ クリレート、ポリカーボネート、ポリアリレート、トリ アセチルセルロース、ポリエーテルスルフォンなどが好 ましく用いられる。また、光学的に異方性であっても、 液晶表示装置にとって必要な部材である場合には、その まま使用することができる。このような例としては、ポ リカーボネートやポリスチレンなどのプラスチックフィ ルムを延伸して得られる位相差フィルム、偏光フィルム などが挙げられる。

【0301】さらに、用いられる第二の基板の例として 液晶表示セルそのものを挙げることができる。液晶表示 セルは、通常上下2枚の電極付きガラス基板を用いてお り、この上下いずれか、あるいは両面のガラス上に本発 明の補償フィルムを転写すれば、本補償フィルムの組み 込みがすでに達成されたことになる。また表示セルを形 成するガラス基板そのものを配向基板として本発明の補 償フィルムを製造することも、もちろん可能である。転 写に用いられる第二の基板と本発明の補償フィルムとを 貼り付ける接着剤または粘着剤は、光学グレードのもの であれば特に制限はないが、アクリル系、エポキシ系、 エチレン-酢酸ビニル共重合体系、ゴム系などを用いる ことができる。

【0302】本発明の補償フィルムを液晶表示素子に適 した第二の基板へ転写する工程は、第二の基板の接着後 に配向基板を該フィルムとの界面で剥離することにより

が、ロールなどを用いて機械的に剥離する方法、構造材料すべてに対する貧溶媒に浸漬した後機械的に剥離する方法、貧溶媒中で超音波をあてて剥離する方法、配向基板と該光学フィルムとの熱膨張係数の差を利用して温度変化を与えて剥離する方法、配向基板そのもの、または配向基板上の配向膜を溶解除去する方法などを例示することができる。剥離性は、用いるディスコティック液晶性材料と配向基板の密着性によって異なるため、その系に最も適した方法を採用すべきである。また本発明の補償フィルムには、必要であれば表面の保護のために透明 10プラスチックフィルムなどの保護層などを設けることもできる。

【0303】本発明の補償フィルムが十分な光学的性能 を発揮するためには、補償フィルムの膜厚、ねじれ角、 ねじれの方向、およびフィルムの三次元方向の屈折率を 液晶表示セルに応じマッチングさせることが必要であ る。これらの制御方法としては、補償フィルムの膜厚に ついては上述の通り塗布時の溶液濃度の制御による方 法、ねじれ角については液晶性材料中の光学活性基の添 加量により制御する方法、ねじれの方向については使用 20 する光学活性物質の鏡像体の選択などを例示できる。さ らに、フィルムの三次元方向の屈折率を制御する方法と しては、使用する液晶材料の種類を適宜選択することに より固有屈折率楕円体の形状を変化させる、あるいはラ ビング条件などアンカリング条件を変更したり、配向時 に電場、磁場などの外場を作用させることによりフィル ム内のディスコティック液晶分子のチルト角をコントロ ールする、などの方法を例示することができる。

【0304】本発明の液晶性光学フィルムから成る、液晶表示素子用補償フィルムは、光学的に異方性をもった 30 液晶ディスプレー、好ましくは光学的に異方性を持つと同時に、液晶セルの液晶が40~360度、好ましくは60~300度の範囲のねじれ角を有するねじれ構造を有した液晶ディスプレーが補償の対象である。該液晶ディスプレーの種類については、特に限定されないが,具体的な例を示せば、単純マトリックス方式もしくはアクティブマトリックス方式のTN(Twisted Nematic液晶ディスプレー、またはSTN(Super Twisted Nematic)液晶ディスプレーなどのねじれネマチック液晶配向を利用したディスプレーなどのねじれネマチック液晶配向を利用したディスプレーを挙げることができる。また表示システムの方式としては、それぞれについて直視型、投射型、反射型がある。

【0305】本発明の液晶性光学フィルムから成る補償フィルムが有すべきねじれ角は、対象とする液晶セルの構造に大きく依存する。一般にねじれを持つ液晶セルには、ノーマリーホワイト (NW) およびノーマリーブラック (NB) の二種類のモードが存在する。例えば非選択の状態、すなわち液晶セル中の液晶分子の多くが面内方向を向き、面内のリターデーションが最大となる状態 50

においてNWモードでは白色を表示し、NBモードでは 逆に黒色を表示する。この時には透過光が感じる液晶セ ルのねじれ角が最大となる。一方、選択の状態、すなわ ち液晶分子の多くが基板法線方向を向き、面内のリター デーションが最小となる状態においては、NWモードで は黒色が表示され、NBモードでは白色が表示される。 このとき透過光が感じる液晶セルのねじれは最小とな る。

【0306】従って、例えば黒色を表示する状態において補償を行おうとしても、ねじれが最小の状態のNWモードと、ねじれが最大の状態のNBモードの両モードでは、補償フィルムが対応すべきねじれの度合いは大きく異なる。しかし、このような広範囲のねじれ角の補償に対しても、本発明の液晶性光学フィルムから成る補償フィルムは、ディスコティック液晶性材料の種類および/または該材料中に占める光学活性な化合物の含有量あるいは光学活性な置換基成分濃度を調節することにより容易に対応させることができることを強調しておく。

【0307】本発明の補償フィルムの配置位置に付いて説明する。本補償フィルムの配置位置は液晶ディスプレーの2枚の偏光板の間であればどこでもよく、1枚または複数枚の補償フィルムを配置することができる。本発明では、1枚または2枚の補償フィルムを用いることが実用上好ましい。3枚以上の補償フィルムを用いることがてまりましいとはいえない。また、従来の光学フィルム、をとえば負の一軸性屈折率構造をもつフィルムや、正の一軸性屈折率構造をもつフィルムを併せて使用することも可能である。但し、視野角補償などの補償効果に対して決定的な役割を果たすのは本発明の補償フィルムであり、他の従来の光学フィルム、補償板のみを如何様に組み合わせて用いたとしても、本発明の補償フィルムのような顕著な補償効果は得ることができない。

【0308】本発明の補償フィルムを1枚または複数枚備えた液晶表示装置は、従来から問題となっていた視角によるコントラスト、色調などの改善に大きく寄与するものであり、例えばディスプレーを大面積化しようとする場合において、画面中央部と周辺部との表示の質の差を大幅に軽減することができる。以上のように本発明の液晶性光学フィルムからなる液晶表示素子用補償フィルムは、液晶ディスプレーに本質的な屈折率異方性およびねじれが視角および色調に与える影響を軽減することを可能にすることで液晶ディスプレーの高性能化および大面積化に寄与でき、きわめて工業的な価値の大きなものである。

[0309]

【実施例】以下に実施例を述べるが、本発明はこれらに 制限されるものではない。なお実施例で用いた各分析法 は以下の通りである。

【0310】(化学構造決定)400MHzの1H-N

MR (日本電子製 J NM-G X 4 0 0) で測定した。

(光学顕微鏡観察) オリンパス製の偏光顕微鏡 B X - 5 0 を用いて、オルソスコープ観察およびコノスコープ観察を行った。また、液晶相の同定はメトラーホットステージ (F P - 8 0) 上で加熱しながらテクスチャー観察することにより行った。

(偏光解析) (株) 溝尻光学工業所製エリプソメーター DVA-36VWLDを用いて行った。

(屈折率測定) アタゴ (株) 製アッベ屈折計 Type - 4 Tを用いて行った。

(膜厚測定) (株) 小坂研究所製高精度薄膜段差測定器 ET-10を主に用いた。また、干渉波測定(日本分光 紫外・可視・近赤外分光光度計V-570) と屈折率 のデータから膜厚を求める方法も併用した。

(視野角特性)液晶表示素子正面でのコントラスト特性の評価および視野角特性の評価は(株)トプコン社製色 彩輝度計BM-7を用いて行った。

【0311】 (フィルムの配向形態解析) 本発明の液晶 性光学フィルムの配向形態の解析は、以下に述べる測定 およびシミュレーションによる解析を組み合わせて行っ た。先ず、見かけのリターデーションは、ベレックコン ペンセーターを用いた偏光顕微鏡下の観察によって求め た。フィルム界面近傍の屈折率は、アッベ屈折計により 求めた。但しこの際、空気界面側のフィルム界面近傍の 屈折率測定は、中間液としてイオウのヨードメタン飽和 溶液を用い、該溶液をフィルム上に塗布し測定を行っ た。また、ラビング界面側のフィルム界面近傍の屈折率 測定は、適当な表面処理を施した高屈折率ガラス(屈折 率1.84)を基板としてアッベ屈折計により求めた。 この結果、得られる界面での屈折率の値および屈折率異 方性から界面近傍での分子配向状態を推定・決定した。 【0312】一方見かけのねじれ角は、偏光顕微鏡下の 観察により測定した。1ピッチ(ダイレクターが360 度回転するに要する膜厚) 当たりのリターデーション が、測定光である可視光波長より十分小さい場合には、 クロスニコル状態での消光軸のラビング軸からの方位角 より求めた。但しここで言う消光軸とは、厳密な意味で の消光軸ではなく、透過光強度がゼロとなる必要はなく 最小値を与える方向を意味する。また消光軸はラビング 軸を該方位角だけ回転した方向を向き、ラビング軸と同 40 一平面上にある。この時構造A(図4)または構造B

(図5)の如きねじれ配向を形成した際には、消光軸は実際のねじれ角の大凡半分の角度に現れる。また構造C(図6)、構造D(図7)または構造E(図8)の如きねじれ配向を形成した際には、ねじれがチルト角の大なる部分または小なる部分のどちらで多く発生しているかにより消光軸と実際のねじれ角との関係は異なる。チルト角が小さい部分、すなわちリターデーションへの影響が少ない部分において主にねじれが発生し、チルト角が大きい部分においてねじれが少ない場合には、実際のね50

136

じね角と消光軸の方位角はほぼ等しくなる。逆にチルト 角が小さい部分でねじれが少なく、チルト角が大きい部 分で主にねじれが発生している場合には、ねじれ角は消 光軸方位角の2倍に近くなる。 ねじれの発生がチルト角 大または小のどちらの領域で多く発生しているかは、光 学活性な置換基濃度が異なる種々のサンプルを作成し、 それぞれの見かけのリターデーションを測定し、光学活 性濃度による見かけのリターデーションの変化により判 断することができる。具体的には、チルト角が大きい部 分において、ねじれが多く発生しているのであれば、ね じれにより面内異方性が解消するためリターデーション はフィルムの厚さ方向に平均化され、小さくなる。また 逆にチルト角が小さい部分でねじれが多く発生している 場合には、ねじれによるリターデーションの変化はほと んどない。以上の結果より、ねじれの発生領域が判断で きる。また1ピッチ当たりのリターデーションが、測定 光である可視光波長と同程度またはそれ以上の場合に は、ラビング軸と下偏光板軸を一致させ上偏光板軸の角 度を変化させることにより、ねじれ角を求めた。またウ ェーブガイド法を用いてもこの場合には、ねじれ角およ びリターデーションを求めることもできる。さらに正確 なリターデーション、ねじれ角およびフィルム内部の配 向形態を解析する際には、入射偏光の入射角度、方位 角、楕円率を変化させながら出射光の偏光解析を行っ た。この結果をベレマンの4×4マトリックス法(D. W. Berreman, Phys. Rev. Let t., 28, 1683 (1972)) または拡張ジョー ンズ行列法 (P. Yeh, J, Opt. Soc. A m., 72, 507 (1982)) によるシミュレーシ ョンに基づく計算結果と照合することにより詳細な解析 を行った。

【0313】 ディスコティック液晶性化合物の調製なお、以下に示す液晶性化合物の調製に用いた光学活性な化合物の光学純度は、全て99%以上である。

(調製1) 2, 3, 6, 7, 10, 11— \wedge キサアセトキシトリフェニレン $5 \, \text{mmol}$ 、4-(R)-1-メチルへプチルオキシ)安息香酸 $30 \, \text{mmol}$ をガラスフラスコ中窒素雰囲気下で激しく撹拌しながら $250 \, ^{\circ}$ で8時間脱酢酸反応を行い、 \wedge キサキス (R) -1-メチルへプチルオキシベンゾイロキシ)トリフェニレン(液晶性化合物 1)を得た。

(調製 2) 3, 4-EZ ((R) -(2-メチルブトキ)) 安息香酸と塩化チオニルから合成した 3, 4-EZ ス ((R) -(2-メチルブトキシ)) 安息香酸クロライド $40\,\text{mmole}$ 1と 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 1 3-オクタヒドロキシジベンゾ [fg, op] ナフタセン $5\,\text{mmole}$ ピリジン $20\,\text{0ml}$ 中で混合し、室温で4時間、 $10\,\text{0}$ で $8\,\text{時間反応させた}$ 。溶媒を減圧下エパポレーターにより留去した後 $1\,\text{N塩酸}\,2\,0\,\text{0mle}$ かえ、酢酸エチル $2\,0\,\text{0ml}$ で二回抽出した。有機層を飽

和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒留去後フラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製し、オクタキス(ビス((R) - (2-メチルブトキシ))ベンゾイル)ジベンゾ [fg, op] ナフタセン(液晶性化合物 2)を得た。

【0314】(調製3)2,3,6,7,10,11-ヘキサアセトキシトルクセン5.5 mmol、1,3, 5-トリアセトキシベンゼン1 mmol、4-((R) -1-メチルヘキシルオキシ) 桂皮酸30 mmolを用 い調製1と同様の操作を行い(液晶性化合物3)を得 た。

(調製4) 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセト キシトリフェニレン5mmol、6-ヘキシルオキシー 2-ナフトエ酸15mmol、4-ペンチロキシ安息香 酸15mmolを用い、調製1と同様の操作を行い光学 活性基を持たない(液晶性化合物4)を得た。

(調製5) 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-オクタアセトキシジベンゾ [fg, op] ナフタセン5mm ol、4'ーヘプチルオキシ [1, 1'ービフェニル]ー4ーカルボン酸8mmol、4ーヘキシロキシ安息香 20酸30mmol、ステアリン酸2mmolを用い、調製1と同様の操作を行い光学活性基を持たない(液晶性化合物5)を得た。

【0315】 (調製6) 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセトキシトリフェニレン5mmol、4-((R)-1-メチルヘプチルオキシ) 安息香酸3mm ol、4-ヘプチルオキシ安息香酸15mmol、4-ブトキシ安息香酸12mmolを用い調製1と同様の操

作を行い(液晶性化合物6)を得た。

(調製 7) 2, 3, 6, 7, 10, 11- \wedge キサアセト キシトリフェニレン $5 \, \text{mmo} \, 1$ 、3, 4 - ビス (ペンチルオキシ) 安息香酸 $2 \, 7 \, \text{mmo} \, 1$ 、および二官能性の側鎖成分として 4, 4' - ((R) $-3 - \text{メチル} \wedge$ キサン -1, 6 - ジイルビス (オキシ)) ビス安息香酸 1. $5 \, \text{mmo} \, 1$ を用いて調製 1 と同様の操作を行い(液晶性化 6 物 7)を得た。

(調製8) 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセト キシトリフェニレン5mmol、4-((-)-メンチ ルオキシ) 安息香酸10mmol、4-ヘキシルオキシ フェニル酢酸20mmolを用いて調製1と同様の操作 40 を行い(液晶性化合物8)を得た。

【0316】(調製9) 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセトキシトリフェノレン5mmol、4-

((s)-1-メチルへプチルオキシ)安息香酸30mmolをガラスフラスコ中、窒素雰囲気下で激しく攪拌しながら250℃、8時間脱酢酸反応を行い、ヘキサキス((SR)-1-メチルヘプチルオキシベンゾイルオキシ)トリフェニレン(液晶性化合物9)を得た。

(調製10) 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサアセ 5°、24は0°、25は45°、26は90°に設定トキシトリフェノレン5mmol、4-プトキシ安息香 50 する。ネマチック液晶9にはメルク社製の液晶 Z L I -

酸17.5mmol、4-ヘプチルオキシ安息香酸1 2.5mmolを用い、調製1と同様の操作を行い、光 学活性な置換基を有しない液晶性化合物10を得た。

(調製11) 液晶性化合物4を8部、液晶性化合物10を2部混合して、光学活性な置換基を有しない液晶性化合物11を得た。

【0317】 (実施例1) 液晶性化合物2を3部、液晶 性化合物5を7部を混合して液晶材料濃度が10重量% となるようにフェノール/テトラクロロエタン (60/ 40重量比)の光学活性な置換基成分濃度30モル%の ディスコティック液晶性材料溶液を調製した。この溶液 を用いて、表面にSiО2をスパッタリング製膜した1 50mm×230mmの大きさで厚さ1mmの高屈折率 ガラス基板上に、スクリーン印刷機を用いてキャストし た後に乾燥し、230℃で30分間熱処理を行い、次に 冷却した均一なモノドメインの構造を固定化し透明な液 晶性光学フィルム1を得た。偏光解析のウェーブガイド 法による測定の結果、該フィルムのねじれ角は-240 (右ねじれ)、リターデーションは817nm、であ ることがわかった。また、ガラス基板界面近傍のフィル ムの屈折率は、スパッタリングの垂直方向で1.66、 スパッタリング方向に1.56であり、空気界面近傍に おけるフィルムの屈折率もスパッタリングの垂直方向か ら-240°、ねじった方向に1.66、その垂直方向 に1.56であり、該液晶性材料本来の屈折率異方性と ほぼ一致することから、両界面近傍における分子のチル ト角はほぼ90°であることがわかった。これらの測定 結果とさらに詳細な偏光解析の結果、本フィルムの平均 のチルト角はほぼ90°であり、図4(構造A)のよう な配向形態を形成していることがわかった。次に該フィ ルムを補償フィルムとしてガラス基板面を液晶セルの上 基板に貼合し、作製した液晶表示素子の視野角特性を評 価した。本発明の実施例1における液晶表示素子は、図 10に示すように、上側偏光板1、補償フィルム2、液 晶セル3、下側偏光板4、液晶セルの上基板5、液晶セ ルの下基板6、透明電極7、配向膜8、ネマチック液晶 9で構成され、またその軸配置は図5-2に示すよう に、上偏光板の吸収軸を11、下偏光板の吸収軸を1 2、液晶セルの上基板での液晶の配向方向を13、液晶 セルの下基板での液晶の配向方向を14、補償フィルム と上偏光板が接する面側での補償フィルム中の液晶分子 の配向方向を15、補償フィルムと液晶セルの接する面 側での補償フィルム中の液晶分子の配向方向を16、1 3と14から決まる液晶セルのねじれ角を21、15と 16から決まる補償フィルムのねじれ角を22、11と 15のなす角を23、13と16のなす角を24、12 と14のなす角を25、11と12のなす角を26、と すると、21は240°、22は-240°、23は4 5°、24は0°、25は45°、26は90°に設定

2293にBDH社製のカイラルドーパントCB-15を添加したものを用いた。使用したセルのセルギャップは6.2 μ mとし、配向膜8にはポリイミド膜を用いプレチルト角約3°でホモジニアス配向させた。以上のように作製した本発明の実施例9における液晶表示素子に1/240デューティ、1/15バイアス、フレーカーで数100Hzの駆動電圧を印加し、液晶表示素子の調測したときに最大コントラストを与える駆動電圧において視野角特性を評価した。図13に本発明の実施例9における液晶表示素子の視野角特性を示す。この視野角特性を図12に示した従来の補償フィルムを使用したものと比較すると30:1の等コントラスト曲線で左右に20度以上広がっていることがわかる。また、上下に関しても従来品と同等以上の特性を示しており、全体的に視野角特性が拡大していることがわかる。

【0318】 (実施例2) 液晶性化合物1を4部、液晶 性化合物3を4部、液晶性化合物4を17部および液晶 性化合物7を5部混合して液晶材料濃度が10重量%と なるようにフェノール/テトラクロロエタン (60/4 0重量比)のディスコティック液晶性材料(光学活性な 置換基成分濃度2.0モル%)溶液を調製した。この溶 液を用いて、表面にSiO2をスパッタリング製膜した 50mm×50mmの大きさで厚さ1mmのガラス基板 上に、スピンコート法を用いて塗布した後に乾燥し、基 板に平行方向に2kGの磁場を印加しながら240℃で 20分間熱処理を行い、次に冷却して均一なモノドメイ ンの構造を固定化し、透明な液晶性光学フィルム2を得 た。ウェーブガイド法による測定結果より、該フィルム のねじれ角は-120° (右ねじれ)、リターデーショ ンは410nmであることがわかった。また実施例1と 同様に屈折率測定の結果、両界面のチルト角は、ガラス 基板面でほぼ90°、空気界面ではほぼ80°であるこ とがわかった。本フィルムの配向形態をさらに詳細に調 べるために、磁場を用いない以外は、全て上記実験と同 様な操作を行い、比較用フィルムを作成した。比較用フ ィルムは、両界面のチルト角はほぼ90°であり、リタ ーデーションは510nmであったる他の要素はほぼ同 一であるにもかかわらず、磁場をかけて作成したフィル ムのリターデーションが410nmと減少することか ら、フィルム内部において液晶分子のチルト角が増加 し、上面および下面のチルト角は若干異なるが図7(構 造D)のような構造であることが示唆された。さらに詳 細な偏光解析により、本フィルムの配向形態が図7(構 造D) のようなものであることが確認できた。次に該フ ィルムを補償フィルムとして液晶セルの上下両面にガラ ス基板面と液晶セルの基板が接するように貼合し、作製 した液晶表示素子の視野角特性を評価した。本発明の実 施例2における液晶表示素子は、図14に示すように、 上側偏光板1、上側補償フィルム2、液晶セル3、下側 補償フィルム2'、下側偏光板4、液晶セルの上基板

5、液晶セルの下基板6、透明電極7、配向膜8、ネマ チック液晶9で構成され、またその軸配置は図15に示 すように上偏光板の吸収軸を11、下偏光板の吸収軸を 12、液晶セルの上基板での液晶の配向方向を13、液 晶セルの下基板での液晶の配向方向を14、上側補償フ ィルムと上側偏光板が接する面側での上側補償フィルム 中の液晶分子の配向方向を15、上側補償フィルムと液 晶セルの接する面側での上側補償フィルム中の液晶分子 の配向方向を16、下側補償フィルムと下側偏光板が接 する面側での下側補償フィルム中の液晶分子の配向方向 を17、下側補償フィルムと液晶セルの接する面側での 下側補償フィルム中の液晶分子の配向方向を18、13 と14から決まる液晶セルのねじれ角を21、15と1 6から決まる上側補償フィルムのねじれ角を22、17 と18から決まる下側補償フィルムのねじれ角を2 2'、11と15のなす角を23、13と16のなす角 を24、12と17のなす角を23'、14と18のな す角を24'、11と12のなす角を25とすると、2 1 t 2 4 0° 、 2 2 t - 1 2 0° 、 2 2' t - 1 2 0 °, 23 t 45°, 23' t 45°, 24 t 0°, 25 は90°に設定する。ネマチック液晶9にはメルク社製 の液晶乙LI-2293にBDH社製のカイラルドーパ ントCB-15を添加したものを用いた。使用したセル のセルギャップは6. 2μmとし、配向膜8にはポリイ ミド膜を用いプレチルト角約3°でホモジニアス配向さ せた。以上のように作製した本発明の実施例2における 液晶表示素子に1/240デューティ、1/15バイア ス、フレーム周波数100Hzの駆動電圧を印加し、液 晶表示素子を正面から観測したときに最大コントラスト を与える駆動電圧において視野角特性を評価した。図1 6に本発明の実施例2における液晶表示素子の視野角特 性を示す。この視野角特性を図12に示した従来の補償 フィルムを使用したものと比較すると30:1の等コン トラスト曲線で上下左右に30度以上広がっていること がわかる。また、従来品で生じていたコントラスト比が 1:1以下の領域、すなわち反転領域が実施例2におけ る液晶表示素子では大幅に減少しており、視野角特性が 大幅に拡大していることがわかる。

【0319】(実施例3)液晶性化合物4を20部、液 40 晶性化合物6を0.5部および液晶性化合物8を0.5 部をクロロホルムに溶解し、液晶材料濃度として8重量 %に調整した光学活性な置換基成分濃度1.0モル%の ディスコティック液晶性材料溶液を得た後、ラビングポ リイミド膜を有する15cm角のガラス基板上にスピン コート法により塗布した。次いで45℃のホットプレー ト上で乾燥し、オーブン中220℃で15分間熱処理し た後、室温中に取り出して冷却し、基板上の厚さ1.1 μmの透明な液晶性光学フィルム3を得た。該フィルム の配向形態は、実施例1および2と同様な両界面での屈 50 折率測定、偏光解析の結果、図8(構造E)に示したよ

であり、遅相軸は空気界面においては剥離前のラビングポリイミドフィルムのラビング方向に対応する方向に垂直な方位にあり、粘着層界面ではそれより45°回転した方位にあった。次に該フィルムを2枚用い、実施例3で用いたTNセルに対し図19のように配置し、ノーマリーブラックモードの液晶素子を作成した。駆動電圧は

142

リーブラックモードの液晶素子を作成した。駆動電圧は 2 V と 6 V で二値表示を行い、2 V で着色のない完全な 黒表示、6 V で白表示が得られた。また、図 2 0 に示し たように、視野角の広い表示が得られた。 【0322】(実施例5)液晶性化合物11に液晶性化

合物1を光学活性な置換基成分濃度が0.25、0. 5, 0. 75, 1. 0, 1. 5, 2. 0, 2. 5, 3. 0、4.0、5.0重量%となるように適宜混合し、そ れぞれの濃度のディスコティック液晶性材料を15%ブ チルセロソルブ溶液として調製した。該溶液を、表面に ラビングポリイミド膜を作成したガラス板にスピンコー ト方により、10種類の濃度の該溶液をそれぞれ、熱処 理後の膜厚が 0.8 μ m、 1.0 μ m、 1.4 μ m とな るように塗布した。続いて、80℃で30分乾燥、22 0℃で15分熱処理を行い液晶性光学フィルムを得た。 該フィルムは、いずれもモノドメインとなり透明性の良 いものであった。先ず、それぞれのフィルムのリターデ ーションをベレックコンペンセーターを用いた方法によ り求めたところ、膜厚 0. 8 μ m で約 3 0 n m、膜厚 1. 0 μ m で約35 n m 、 膜厚1. 4 μ m で約50 n m となり、光学活性濃度による大きな変化は認められなか った。このことから、ねじれは主にチルト角が小さい部 分で生じ、チルト角が大きい部分でのねじれは小さいと 判断された。したがってねじね角は消光軸方位角にほぼ 等しいことがわかった。これらのフィルムの膜厚を干渉 法により、ねじれ角をラビング軸を基準とした消光軸方 位の測定により求めた。図2に光学活性な置換基成分濃 度と見かけのねじれ角との関係を図示した。図2より、 光学活性濃度および膜厚が増加することによってねじれ 角が増大していることがわかる。なお、ねじれの方向は 全て右回りであった。液晶性化合物1の替わりに、その 鏡像体である液晶性化合物9を用いて、光学活性濃度が 異なる10種の液晶性材料および15%ブチルセロソル ブ溶液を調製し、同様の実験を行った。結果、ねじれの 方向が左回りとなった以外は、ほぼ上記の結果と同様の 結果が得られた。

【0323】以上、60種のフィルムのガラス面側の屈 折率は、いずれもラビング方向、ラビングに垂直な方向 とも約1.66であり、異方性は認められなかった。こ のことから、それぞれのフィルムのチルト角はほぼ0° に近いことがわかった。一方空気界面での屈折率は、い ずれのフィルムもラビング方向からそれぞれのフィルム のねじね角分だけ回転した方向で約1.66、それに垂 直な方向で約1.56であり、該界面でのチルト角はほ 50 ぼ90°に近いことが詳細な解析より判明した。このこ

うな、ねじれ構造を有すると同時に膜厚方向でダイレク ターの方向が変化するハイブリッド構造を有しているこ とがわかった。フィルム正面から見たとき、見かけ上、 リターデーションは30nmで、液晶のダイレクターと フィルム法線のなす角は、空気界面で約90°、ラビン グポリイミドガラス基板界面では約0°であった。また 見かけ上、ねじれは右巻きで12°であり、遅相軸はラ ビングポリイミドガラス界面においてはラビング方向と 垂直な方位にあり、空気界面側ではそれより12°回転 した方位にあった。次に該フィルムを2枚用いて、図1 7の(a) および(b) に記載したような構成でNWモ ードのTN液晶素子に対する視野角補償効果を調べた。 TN液晶セルの作成は、まず2枚のラビングポリイミド 膜を有するITO電極基板を互いにラビング方向が直交 するように重ね4. 7μmのギャップを形成させた後、 この間にBDH社製CB-15を少量添加したメルク社 製液晶ZLIー3771を挟むことにより行った。得ら れた液晶セルは90°左ねじれで電圧無印可時のリター デーションは490nmであった。駆動電圧2Vと6V で二値表示をを行った結果、図18に示したように、該 20 フィルムにより視野角が大きく広がることを確認でき た。

【0320】 (実施例4) 液晶性化合物4を20部、液 晶性化合物6を1部および液晶性化合物8を0.5部を ブチルセロソルブに溶かし液晶材料濃度として30重量 %のディスコティック液晶性材料溶液(光学活性な置換 基成分濃度1.3モル%)を調製した。次いで、ロール コーターにより幅25cmのラビングポリイミドフィル ム (厚さ100μmのデュポン社製カプトンフィルムを ラビングしたもの)に10cmにわたって塗布した。7 0℃の熱風で乾燥し、250℃で2分熱処理した後、冷 却して液晶相を固定化したラビングポリイミドフィルム 上の厚さ4. 1μmの液晶性光学フィルム4を得た。次 に、ポリイミドフィルムが透明性に欠けティスプレー用 途として用いるには問題があるため、液晶性光学フィル ムを光学グレードのポリエーテルスルフォンに粘着剤を 介して転写した。操作は粘着処理を施したポリエーテル スルフォンとラビングポリイミドフィルム上のフィルム 4とを、粘着相とフィルム4が接するようにして張り合 わせ、次いでラビングポリイミドフィルムを剥離するこ とにより行った。

【0321】粘着相を有するポリエーテルスルフォン上のフィルム4は、前記実施例の如き両界面での屈折率測定、偏光解析の結果、図8(構造E)に示したような、ねじれ構造を有すると同時に膜厚方向でダイレクターの方向が変化するハイブリッド構造を有することがわかった。フィルム正面から見たとき、見かけのリターデーションは240nmで液晶のダイレクターとフィルム法線のなす角は、空気界面で約30°、粘着層界面では約90°であった。また見かけ上、ねじれは右巻きで45°

とから、いずれのフィルムも図8構造Eの如きねじれ配向を形成していることが明らかとなった。これらの液晶性光学フィルムを、それぞれ補償フィルムとして2枚ずつ用い、図22の(a)および(b)に記載した構成でもってNWモードのTN液晶装置に対する視野角改良効果を調べた。なお、TNセルの作成および駆動方式は、実施例3と同様に行った。結果を図23に示した。図23において、◎は視野角改良効果が大きく認められた方向、○は視野角改良効果が認められた方向、○は視野角改良効果が認められた方向を意味する。ま 10た4個のマス目は、それぞれ左上が上、右上が下、左下が左、右下が右の方向を意味する。

[0324]

【発明の効果】本発明の液晶性光学フィルムは、ディスコティック液晶性材料に起因する特異な配向形態を固定化したフィルムであり、従来に見られない光学的特性を持った優れた光学フィルムである。また本発明の液晶性光学フィルムからなる液晶表示素子用補償フィルムは、液晶ディスプレイに本質的な屈折率異方性およびねじれが視角および色調に与える影響を軽減することを可能に20することで液晶ディスプレイの高性能化および大面積化に寄与できると考えられ、きわめて工業的な価値の大きなものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 ディスコティック液晶のもつ固有の屈折率分布とダイレクターについて説明した図。

【図2】 ディスコティイク液晶のとり得る配向形態の 模式図。図中の矢印がダイレクターを意味する。(a) は、ダイレクターがフィルム平面に垂直な負の一軸性構 造(ホメオトロピック配向)。(b)は、ダイレクター 30 がフィルムの平面に対して一定角度チルトした負の一軸 構造(チルト配向)。(c)は、ダイレクターがフィル ムの厚み方向で変化したハイブリッド配向。

【図3】 本発明のねじれ構造において、ディスコティック液晶性化合物のダイレクターが連続的に変化する部分と不連続的に変化する部分との説明図。

- (A) 斜め横から見た図
- (B) 真上から見た図

【図4】 本発明の液晶性光学フィルムが形成することが可能な配向形態の模式図。図中のコイン状のものがデ 40 イスコティック液晶化合物の一分子を意味する。

(構造A)面内方向を向いたダイレクターのねじれ構造。

【図5】 本発明の液晶性光学フィルムが形成すること が可能な配向形態の模式図。図中のコイン状のものがデ ィスコティック液晶化合物の一分子を意味する。

(構造B) 一定のチルト角を持ったねじれ構造。

【図6】 本発明の液晶性光学フィルムが形成することが可能な配向形態の模式図。図中のコイン状のものがディスコティック液晶化合物の一分子を意味する。

144

(構造C) チルト角がフィルムの厚さ方向で変化したね じれ構造。図中のコイン状のものがディスコティック液 晶性化合物の一分子を意味する。

【図7】 本発明の液晶性光学フィルムが形成することが可能な配向形態の模式図。図中のコイン状のものがディスコティック液晶化合物の一分子を意味する。

(構造D) チルト角がフィルムの厚さ方向で変化したね じれ構造。

【図8】 本発明の液晶性光学フィルムが形成すること が可能な配向形態の模式図。図中のコイン状のものがディスコテイック液晶化合物の一分子を意味する。

(構造E)フィルムの上面と下面とのチルト角が異なったねじれ構造。

【図9】 ディスコティック液晶性化合物の概念形状。 【図10】 実施例1で使用した液晶表示素子の構成

1:上偏光板

2:補償フィルム (フィルム1)

3:液晶セル

20 4:下偏光板

図。

5:液晶セル上基板

6:液晶セル下基板

7:透明電極

8:配向膜

9:ネマチック液晶

【図11】 実施例1で使用した液晶表示素子の軸配 置。

11:上偏光板の吸収軸

12:下偏光板の吸収軸

0 13:液晶セルの上基板での液晶の配向方向

14:液晶セルの下基板での液晶の配向方向

15:補償フィルムと上偏光板の接する面側での補償フィルム中の液晶分子の配向方向

16:補償フィルムと液晶セルの接する面側での補償フィルム中の液晶分子の配向方向

21:13と14から決まる液晶セルのねじれ角

22:15と16から決まる補償フィルムのねじれ角

23:11と15のなす角

24:13と16のなす角

25:12と14のなす角

26:11と12のなす角

【図12】 従来の補償フィルムを使用した場合における視野角特性。

【図13】 実施例1の補償フィルムを使用した場合における視野角特性。

【図14】 実施例2で使用した液晶表示素子の構成図。

1:上偏光板

2:上側補償フィルム (フィルム2)

50 2':下側補償フィルム (フィルム3)

3:液晶セル

4:下偏光板

5:液晶セル上基板

6:液晶セル下基板

7:透明電極

8:配向膜

9:ネマチック液晶

【図15】 実施例2で使用した液晶表示素子の構成部 材の軸配置。

11:上偏光板の吸収軸

12:下偏光板の吸収軸

13:液晶セルの上基板での液晶の配向方向

14:液晶セルの下基板での液晶の配向方向

15:上側補償フィルムと上偏光板の接する面側での上

側補償フィルム中の液晶分子の配向方向

16:上側補償フィルムと液晶セルの接する面側での上

側補償フィルム中の液晶分子の配向方向

17:下側補償フィルムと下偏光板の接する面側での上

側補償フィルム中の液晶分子の配向方向

18:下側補償フィルムと液晶セルの接する面側での下 20 ィルム)

側補償フィルム中の液晶分子の配向方向

21:13と14から決まる液晶セルのねじれ角

22:15と16から決まる補償フィルムのねじれ角

23:11と15のなす角

23':12と17のなす角

24:13と16のなす角

24':14と18のなす角

25:11と12のなす角

【図16】 実施例2の補償フィルムを使用した場合に おける視野角特性。

【図17】 実施例3で使用した液晶表示装置の斜視図

(a) および各構成部材の軸配置 (aおよびb)

1:上偏光板

2: T N液晶セル

3:ラビングポリイミド膜を有する上電極基板

4:ラビングポリイミド膜を有する下電極基板

5:下偏光板

6:透明基板上の補償フィルム

7:補償フィルム (フィルム3)

8:基板(ラビングポリイミド膜を有するガラス基板)

9:透明基板上の補償フィルム

10:補償フィルム (フィルム3)

11:基板(ラビングポリイミド膜を有するガラス基

板)

12:上偏光板の透過軸

13:上電極基板のラビング方向

14:下電極基板のラビング方向

15:下偏光板の透過軸

16: 基板のラビング方向

17: 基板のラビング方向

146

【図18】 実施例3で得られた視野角特性(コントラ スト30の等コントラスト曲線)

(a) 補償板なし(図14において部材6.9が無い場 合)

(b) 補償板あり

【図19】 実施例4で使用した液晶表示装置の斜視図

(a) および各構成部材の軸配置 (a およびb)。

1:上偏光板

2:TN液晶セル

10 3:ラビングポリイミド膜を有する上電極基板

4:ラビングポリイミド膜を有する下電極基板

5:下偏光板

6:透明基板上の補償フィルム

7:補償フィルム (フィルム4)

8:基板(粘着層を有するポリエーテルスルフォンフィ

ルム)

9:透明基板上の補償フィルム

10:補償フィルム (フィルム4)

11:基板(粘着層を有するポリエーテルスルフォンフ

12:上偏光板の透過軸

13:上電極基板のラビング方向

14:下電極基板のラビング方向

15:下偏光板の透過軸

16:ポリイミドフィルムのラビング方向に対応する方

17:ポリイミドフィルムのラビング方向に対応する方

【図20】 実施例4で得られた視野角特性(コントラ

30 スト30の等コントラスト曲線)。

【図21】 光学活性な置換基成分濃度と見かけのねじ

れ角との関係図。

【図22】 実施例5で使用した液晶表示装置の斜視図

(a)および軸配置(b)。

1:上偏光板

2: TN液晶セル

3:ラビングポリイミド膜を有する上電極基板

4:ラビングポリイミド膜を有する下電極基板

5:下偏光板

40 6:透明基板上の補償フィルム

7:補償フィルム

8:透明基板(ラビングポリイミド膜を有するガラス基

9:透明基板上の補償フィルム

10:補償フィルム

11:透明基板(ラビングポリイミド膜を有するガラス

基板)

12:上偏光板の透過軸

13:上電極基板のラビング方向

50 14: 下電極基板のラビング方向

15:下偏光板の透過軸

16:補償フィルムの消光軸

*17:補償フィルムの消光軸

* 【図23】 実施例5における視野角改良効果の結果。

【図1】

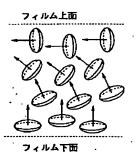
フィルム上面 To>ne

(a) ホメオトロピック配向 (負の一軸性)

71NA L TO

【図2】

(b) チルト配向 (負の一動性)



148

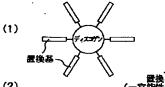
(c) ハイブリッド配向 (光輪舞し)

(B)

【図3】



 $\overline{\mathbb{Q}}$



置換基 置換基 (2) (一官能性置換基) (二官能性置換基)

[図9]

(3) 【図 1 0 】

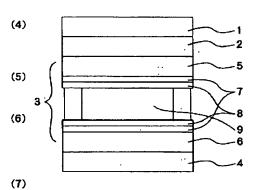
(A)



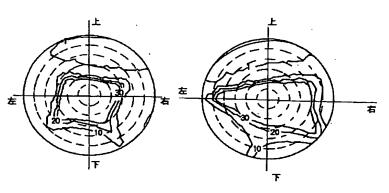




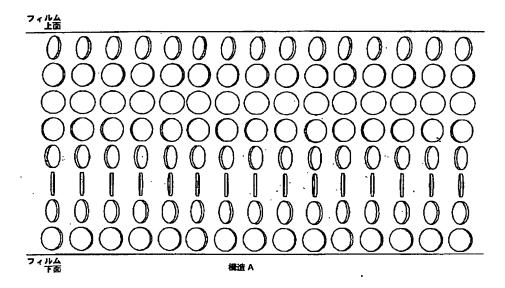
(A) (B) 斜め微から見た図 裏上から見た図 (ダイレクターの フィルム面内成分の向き)



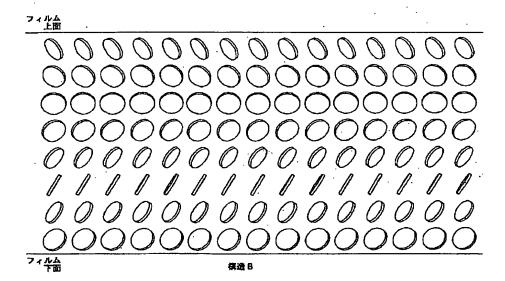
[図12] 【図13】

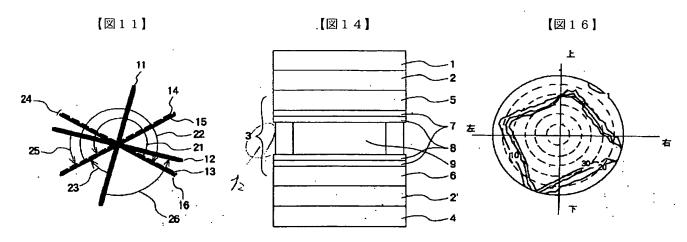


【図4】

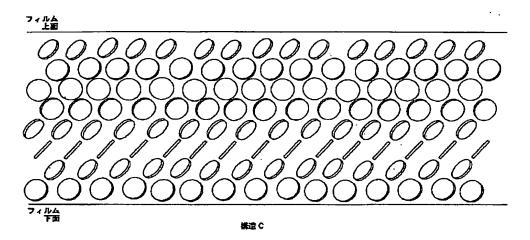


【図5】

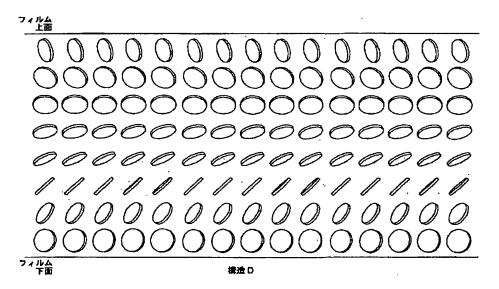


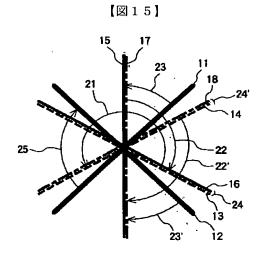


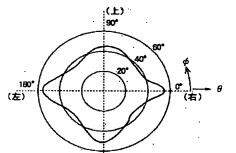
【図6】



【図7】

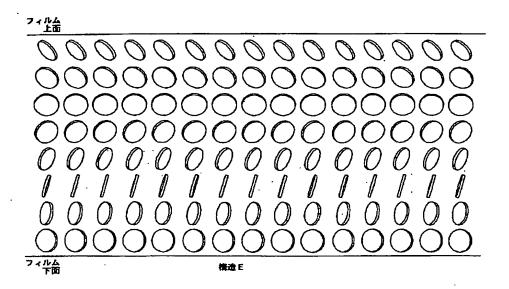






【図20】

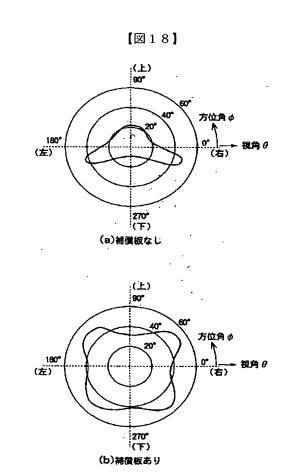
【図8】



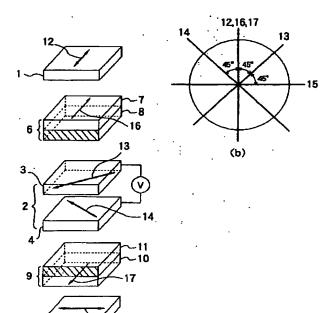
12 12,14,17 13,15,16 13 (b)

14 17 19 (15)

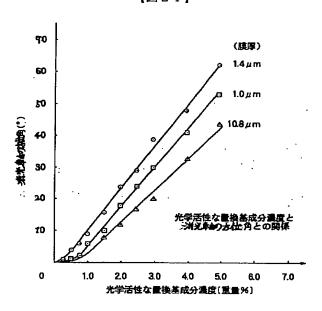
(a)



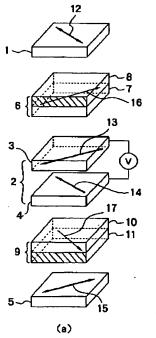
【図19】



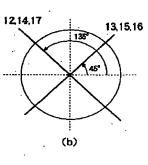
【図21】



【図22】



(a)



【図23】

光学活性な	庭厚(μm)					
ルテルビな 置換基成分退度		R体			S体	
(重量%)	0.8	1.0	1.4	0.8	1.0	1.4
0.25	ΦΔΔ	ΦΦΔΔ		◎ ◎ △	Θ Θ Δ	ΦΔΔ
0.5	∅ ७ Δ Δ	⊚ ⊚ △		© © Δ	Φ Φ Δ	© Φ Δ Δ
0.75	Φ (Φ)		00	© Φ	@ @ Δ Δ	0 O
1.0	Φ Φ Δ	⊚ ⊚ Δ Δ	00	Φ Φ Δ	0 O	0 O
1.5	Φ Φ Δ	0 0 0 0	00	Φ Φ Δ Δ	0 O	0 O
20	⊚ ⊚ Δ	0 0 0 0	00	0 O	0 O	0 O 0 A
2.5	@ @ O O	@ @	О © О Δ	Δ O Δ Δ	Δ O Δ Δ	ΔO ΔO
3.0	⊕ ⊕ ○ Δ	© 0	00	Δ O Δ Δ	ΔO O Δ	Δ O Δ O
4.0	@ O O O	@ Ο Ο Δ	00	Ο Δ Δ Ο	Ο Δ Δ Ο	Δ O O Δ
5.0	00	◎ 0 △ 0	© 0	О <u>Ф</u>	0 Δ 0 Δ	Δ O O Δ

〈根野角改良効果〉 |改良効果が大きく認められた。 |改良効果が認められた。 |改良効果があまり認められなかった。

フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 康司

神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本

石油株式会社中央技術研究所内

(56)参考文献 特開 平2-111918 (JP, A)

特開 平8-50204 (JP, A)

特表 平4-500284 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名) G02F 1/13363